

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5733211号
(P5733211)

(45) 発行日 平成27年6月10日 (2015. 6. 10)

(24) 登録日 平成27年4月24日 (2015. 4. 24)

(51) Int. Cl.

F I

C 0 7 C 39/17 (2006. 01)

C 0 7 C 39/17

C 0 7 C 37/18 (2006. 01)

C 0 7 C 37/18

G 0 3 F 7/004 (2006. 01)

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

G 0 3 F 7/038 (2006. 01)

G 0 3 F 7/004 5 0 1

C 0 7 B 61/00 (2006. 01)

G 0 3 F 7/038 6 0 1

請求項の数 18 (全 46 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2011-528871 (P2011-528871)
 (86) (22) 出願日 平成22年8月27日 (2010. 8. 27)
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2010/064616
 (87) 国際公開番号 W02011/024957
 (87) 国際公開日 平成23年3月3日 (2011. 3. 3)
 審査請求日 平成25年7月25日 (2013. 7. 25)
 (31) 優先権主張番号 特願2009-200632 (P2009-200632)
 (32) 優先日 平成21年8月31日 (2009. 8. 31)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000004466
 三菱瓦斯化学株式会社
 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号
 (74) 代理人 100078732
 弁理士 大谷 保
 (74) 代理人 100081765
 弁理士 東平 正道
 (72) 発明者 越後 雅敏
 神奈川県平塚市東八幡五丁目6番2号 三
 菱瓦斯化学株式会社 平塚研究所内
 (72) 発明者 林 宏美
 神奈川県平塚市東八幡五丁目6番2号 三
 菱瓦斯化学株式会社 平塚研究所内

審査官 吉田 直裕

最終頁に続く

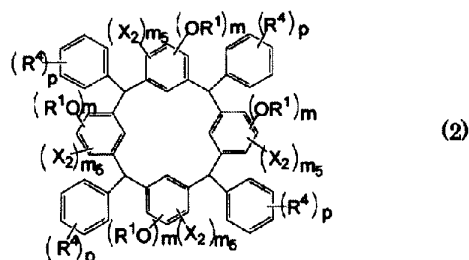
(54) 【発明の名称】 環状化合物、その製造方法、感放射線性組成物およびレジストパターン形成方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記式 (2) で示される環状化合物。

【化 1】



(式 (2) 中、各 R^1 は独立して、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 3 ~ 20 のシクロアルキル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基、複素環基、炭素数 1 ~ 20 のアルキルシリル基、または、水素原子である。但し、少なくともひとつの R^1 は炭素数 1 ~ 20 のアルキル基であり、また別の少なくともひとつの R^1 は水素原子であり、 R^4 は、炭素数 3 ~ 20 のシクロアルキル基であり、 p は 1 ~ 5 の整数であり、 m は 1 ~ 4 の整数である。 X_2 は水素であり、 m_5 は 0 ~ 3 の整数であり、 $m + m_5 = 4$ である。)

【請求項 2】

分子量が800～5000である請求項1に記載の環状化合物。

【請求項3】

アルデヒド性化合物（A1）からなる群より選ばれる1種以上の化合物とフェノール性化合物（A2）からなる群より選ばれる1種以上の化合物とを縮合反応させて環状化合物（A）を得る工程、および、該環状化合物（A）とハロゲン化アルキル（A3）からなる群より選ばれる1種以上の化合物とを脱ハロゲン化水素反応させる工程を含む、請求項1または2に記載の環状化合物の製造方法。

【請求項4】

前記アルデヒド性化合物（A1）が1～4個のホルミル基を有する炭素数が2～59の化合物であり、前記フェノール性化合物（A2）が1～3個のフェノール性水酸基を有する炭素数6～15の化合物である請求項3に記載の製造方法。

10

【請求項5】

前記環状化合物（A）の分子量が700～5000である請求項3または4に記載の製造方法。

【請求項6】

前記環状化合物（A）とハロゲン化アルキル（A3）からなる群より選ばれる1種以上の化合物との脱ハロゲン化水素反応により、前記環状化合物（A）中の少なくとも1つのフェノール性水酸基を変化させることなく、他の少なくとも1つのフェノール性水酸基をアルコキシル基に変換する請求項3～5のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項7】

20

請求項1または2に記載の環状化合物および溶媒を含む感放射線性組成物。

【請求項8】

固形成分1～80重量%および溶媒20～99重量%からなる請求項7に記載の感放射線性組成物。

【請求項9】

前記環状化合物が固形成分全重量の50～99.999重量%である請求項7または8に記載の感放射線性組成物。

【請求項10】

さらに、可視光線、紫外線、エキシマレーザー、電子線、極端紫外線（EUV）、X線、およびイオンビームからなる群から選ばれるいずれかの放射線の照射により直接的又は間接的に酸を発生する酸発生剤（C）を含む請求項7～9のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

30

【請求項11】

さらに、酸架橋剤（G）を含む請求項7～10のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

【請求項12】

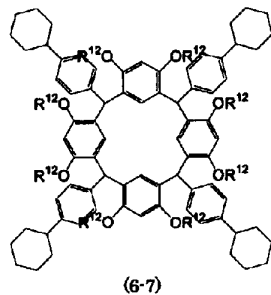
さらに、酸拡散制御剤（E）を含む請求項7～11のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

【請求項13】

前記環状化合物が、下記式（6-7）で示される化合物から選ばれる環状化合物である請求項7～12のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

40

【化 2】



10

(式中、 R^{12} は、炭素数1～20のアルキル基または水素原子である。但し、少なくともひとつの R^{12} は炭素数1～20のアルキル基であり、また別の少なくともひとつの R^{12} は水素原子である。)

【請求項14】

前記固形成分が、環状化合物／酸発生剤(C)／酸架橋剤(G)／酸拡散制御剤(E)／任意成分(F)を、固形成分基準の重量％で、50～99.4／0.001～49／0.5～49／0.001～49／0～49含有する請求項7～13のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

【請求項15】

20

スピコートによりアモルファス膜を形成することができる請求項7～14のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

【請求項16】

前記アモルファス膜の、23℃における2.38重量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液に対する溶解速度が10Å／sec以上である請求項7～15のいずれか1項に記載の感放射線性組成物。

【請求項17】

KrFエキシマレーザー、極端紫外線、電子線またはX線を照射した後の前記アモルファス膜、又は、20～250℃で加熱した後の前記アモルファス膜の2.38重量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液に対する溶解速度が5Å／sec以下である請求項16記載の感放射線性組成物。

30

【請求項18】

請求項7～17のいずれか1項に記載の感放射線性組成物を基板上に塗布してレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を露光する工程、および露光したレジスト膜を現像する工程を含むレジストパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、酸増幅型非高分子系レジスト材料として有用な、特定の化学構造式で示される環状化合物、これを含む感放射線性組成物、および該組成物を用いるレジストパターン形成方法に関する。

40

【背景技術】

【0002】

これまでの一般的なレジスト材料は、アモルファス薄膜を形成可能な高分子系材料である。例えば、ポリメチルメタクリレート、酸解離性反応基を有するポリヒドロキシスチレンまたはポリアルキルメタクリレート等の高分子レジスト材料の溶液を基板上に塗布することにより作製したレジスト薄膜に紫外線、遠紫外線、電子線、極端紫外線(EUV)、X線などを照射することにより、45～100nm程度のラインパターンを形成している。

。

しかしながら、高分子系レジストは分子量が1万～10万程度と大きく、分子量分布も

50

広いため、高分子系レジストを用いるリソグラフィでは、微細パターン表面にラフネスが生じ、パターン寸法を制御することが困難となり、歩留まりが低下する。従って、従来の高分子系レジスト材料を用いるリソグラフィでは微細化に限界がある。より微細なパターンを作製するために、種々の低分子量レジスト材料が提案されている。

例えば、低分子量多核ポリフェノール化合物を主成分として用いるアルカリ現像型のネガ型感放射線性組成物（特許文献１および特許文献２参照）が提案されているが、これらは耐熱性が十分では無く、得られるレジストパターンの形状が悪くなる欠点があった。

低分子量レジスト材料の候補として、低分子量環状ポリフェノール化合物を主成分として用いるアルカリ現像型のネガ型感放射線性組成物（特許文献３および非特許文献１参照）が提案されている。これらの低分子量環状ポリフェノール化合物は、低分子量であるため、分子サイズが小さく、解像性が高く、ラフネスが小さいレジストパターンを与えることが期待される。また低分子量環状ポリフェノール化合物は、その骨格に剛直な環状構造を有することにより、低分子量ながらも高耐熱性を与える。

しかしながら、現在開示されている低分子量環状ポリフェノール化合物は、半導体製造プロセスに用いられる安全溶媒に対する溶解性が低い、感度が低い、および得られるレジストパターン形状が悪い等の問題点があり、低分子量環状ポリフェノール化合物の改良が望まれている。

【０００３】

【特許文献１】特開２００５－３２６８３８号公報

【特許文献２】特開２００８－１４５５３９号公報

【特許文献３】特開２００９－１７３６２３号公報

【非特許文献１】T. Nakayama, M. Nomura, K. Haga, M. Ueda: Bull. Chem. Soc. Jpn., 71, 2979 (1998)

【発明の開示】

【０００４】

本発明の目的は、安全溶媒に対する溶解性が高く、高感度で、かつ、良好なレジストパターン形状を与える環状化合物、その製造方法、それを含む感放射線性組成物、および該感放射線性組成物を用いるレジストパターン形成方法を提供することにある。

【０００５】

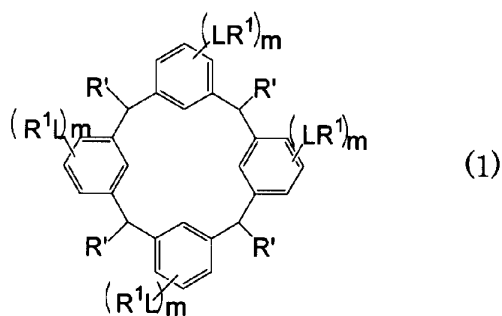
本発明者らは上記課題を解決するため鋭意検討した結果、特定構造を有する環状化合物が安全溶媒に対する溶解性が高く、高感度で、かつ、良好なレジストパターン形状を与えることを見出し本発明に到った。

【０００６】

すなわち、本発明はつぎの通りである。

１． 下記式（１）で示される環状化合物。

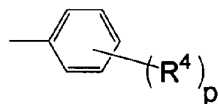
【化１】



（式中、各Lは、独立して、単結合、炭素数１～２０の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基、炭素数３～２０のシクロアルキレン基、炭素数６～２４のアリーレン基、－Ｏ－、－ＯＣ（＝Ｏ）－、－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｎ（Ｒ⁵）－Ｃ（＝Ｏ）－（Ｒ⁵は水素又は炭素数１～１０のアルキル基である）、－Ｎ（Ｒ⁵）－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－（Ｒ⁵は前記と同様）

、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ およびこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される二価の有機基であり、各 R^1 は独立して、炭素数1～20のアルキル基、炭素数3～20のシクロアルキル基、炭素数6～20のアリール基、炭素数1～20のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基、複素環基、ハロゲン、カルボキシ基、炭素数1～20のアルキルシリル基、または、水素原子である。但し、少なくともひとつの R^1 は炭素数1～20のアルキル基であり、また別の少なくともひとつの R^1 は水素原子である。各 R' は独立して、炭素数2～20のアルキル基、又は下記式

【化2】



10

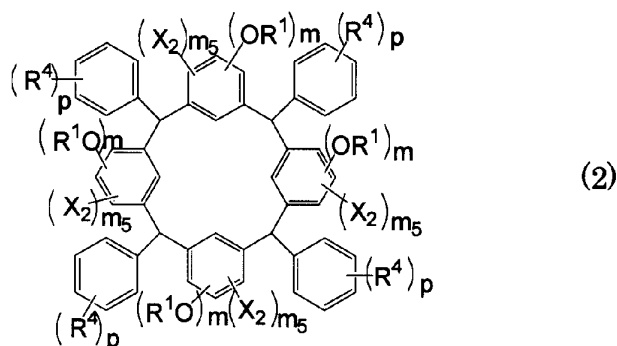
(式中、 R^4 は、炭素数1～20のアルキル基、炭素数3～20のシクロアルキル基、炭素数6～20のアリール基、炭素数1～20のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、複素環基、ハロゲン、カルボキシ基、水酸基、または、炭素数1～20のアルキルシリル基であり、 p は0～5の整数である)

で表わされるアリール基であり、 m は1～4の整数である。)

【0007】

2. 下記式(2)で示される第1項記載の環状化合物。

【化3】



20

(式中、 R^1 、 R^4 、 p 、 m は前記と同様である。 X_2 は水素又はハロゲン原子であり、 m_5 は0～3の整数であり、 $m+m_5=4$ である。)

【0008】

3. 分子量が800～5000である第1または2項に記載の環状化合物。

【0009】

4. アルデヒド性化合物(A1)からなる群より選ばれる1種以上の化合物とフェノール性化合物(A2)からなる群より選ばれる1種以上の化合物とを縮合反応させて環状化合物(A)を得る工程、および、該環状化合物(A)とハロゲン化アルキル(A3)からなる群より選ばれる1種以上の化合物とを脱ハロゲン化水素反応させる工程を含む、第1～3項のいずれかに記載の環状化合物の製造方法。

30

【0010】

5. 前記アルデヒド性化合物(A1)が1～4個のホルミル基を有する炭素数が2～59の化合物であり、前記フェノール性化合物(A2)が1～3個のフェノール性水酸基を有する炭素数6～15の化合物である第4項に記載の製造方法。

【0011】

6. 前記環状化合物(A)の分子量が700～5000である第4または5項に記載の製造方法。

【0012】

7. 前記環状化合物(A)とハロゲン化アルキル(A3)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との脱ハロゲン化水素反応により、前記環状化合物(A)中の少なくとも1つ

40

50

のフェノール性水酸基を変化させることなく、他の少なくとも１つのフェノール性水酸基を炭素数１～２０のアルコキシル基に変換する第４～６項のいずれかに記載の製造方法。

【００１３】

８．第１～３項のいずれかに記載の環状化合物および溶媒を含む感放射線性組成物。

【００１４】

９．固形成分１～８０重量％および溶媒２０～９９重量％からなる第８項に記載の感放射線性組成物。

【００１５】

１０．前記環状化合物が固形成分全重量の５０～９９．９９９重量％である第８または９項に記載の感放射線性組成物。

【００１６】

１１．さらに、可視光線、紫外線、エキシマレーザー、電子線、極端紫外線（ＥＵＶ）、Ｘ線、およびイオンビームからなる群から選ばれるいずれかの放射線の照射により直接的又は間接的に酸を発生する酸発生剤（Ｃ）を含む第８～１０項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

【００１７】

１２．さらに、酸架橋剤（Ｇ）を含む第８～１１項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

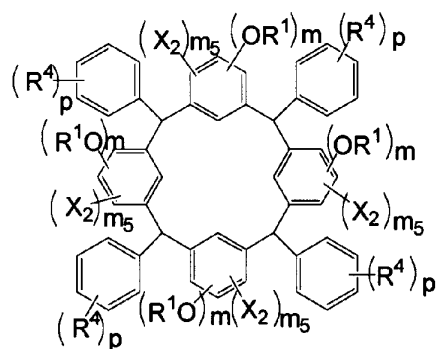
【００１８】

１３．さらに、酸拡散制御剤（Ｅ）を含む第８～１２項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

【００１９】

１４．前記環状化合物が、下記式（２）で示される化合物である第８～１３項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

【化４】



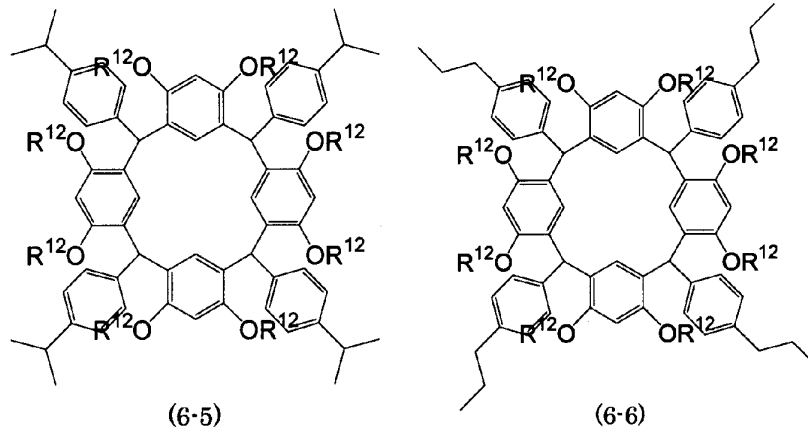
(2)

（式中、 R^1 、 R^4 、 p 、 m は前記と同様である。 X_2 は水素又はハロゲン原子であり、 m_5 は０～３の整数であり、 $m+m_5=4$ である。）

【００２０】

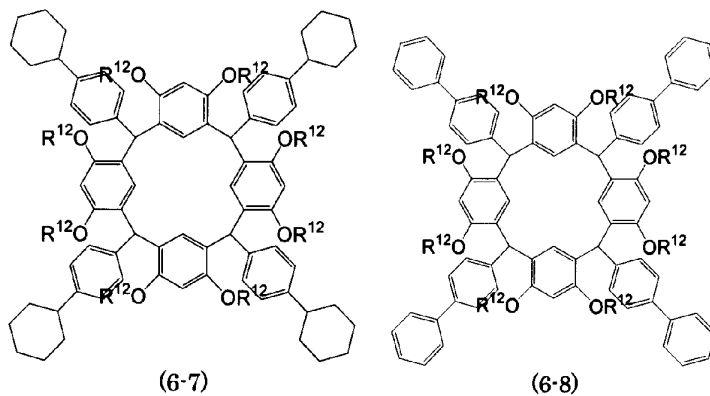
１５．前記環状化合物が、下記式（６－５）～（６－８）で示される化合物からなる群から選ばれる環状化合物である第８～１４項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

【化 5】



10

【化 6】



20

(式中、 R^{12} は、炭素数1～20のアルキル基、または水素原子である。但し、少なくともひとつの R^{12} は炭素数1～20のアルキル基であり、また別の少なくともひとつの R^{12} は水素原子である。)

【0021】

30

16. 前記固形成分が、環状化合物／酸発生剤(C)／酸架橋剤(G)／酸拡散制御剤(E)／任意成分(F))を、固形成分基準の重量％で、50～99.4／0.001～49／0.5～49／0.001～49／0～49含有する第8～15項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

【0022】

17. スピンコートによりアモルファス膜を形成することができる第8～16項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

【0023】

18. 前記アモルファス膜の、23℃における2.38重量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液に対する溶解速度が10Å／sec以上である第8～17項のいずれかに記載の感放射線性組成物。

40

【0024】

19. KrFエキシマレーザー、極端紫外線、電子線またはX線を照射した後の前記アモルファス膜、又は、20～250℃で加熱した後の前記アモルファス膜の2.38重量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液に対する溶解速度が5Å／sec以下である第18項に記載の感放射線性組成物。

【0025】

20. 第8～19項のいずれかに記載の感放射線性組成物を基板上に塗布してレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を露光する工程、および露光したレジスト膜を現像する工程を含むレジストパターン形成方法。

50

【0026】

本発明により、安全溶媒に対する溶解性が高く、高感度でかつ、良好なレジストパターン形状を与える環状化合物、その製造方法、それを含む感放射線性組成物、および該感放射線性組成物を用いるレジストパターン形成方法を提供することができる。

【発明を実施するための形態】

【0027】

以下、本発明を詳細に説明する。

環状化合物およびその製造方法

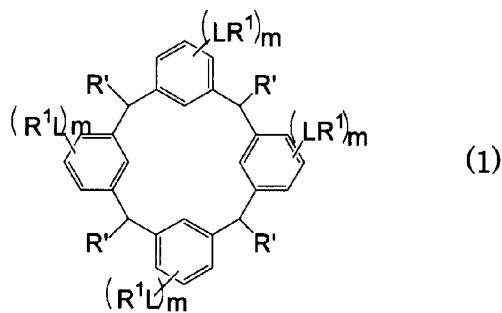
本発明は、レジスト材料として有用な環状化合物およびその製造方法に関する。

本発明の環状化合物は、下記式(1)で示される。

10

【0028】

【化7】



20

【0029】

式中、各Lは、独立して、単結合、炭素数1～20の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基（好ましくはメチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、メチルメチレン、メチルエチレン、ジメチルメチレン、メチルエチレン）、炭素数3～20のシクロアルキレン基（好ましくはシクロプロピレン、シクロブチレン、シクロペンチレン、シクロヘキシレン）、炭素数6～24のアリーレン基（好ましくはフェニレン、ナフチレン、アントラニレン、フェナントリレン）、 $-O-$ 、 $-OC(=O)-$ 、 $-OC(=O)O-$ 、 $-N(R^5)-C(=O)-$ 、 $-N(R^5)-C(=O)O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ およびこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される二価の有機基である。R⁵は水素又は炭素数1～10のアルキル基（好ましくはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、*t*-ブチル）である。

30

【0030】

各R¹は独立して、炭素数1～20のアルキル基（好ましくはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、*t*-ブチル）、炭素数3～20のシクロアルキル基（好ましくはシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル）、炭素数6～20のアリール基（好ましくはフェニル、ナフチル、アントラニル、フェナントリル）、炭素数1～20のアルコキシ基（好ましくはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、*t*-ブトキシ）、シアノ基、ニトロ基、水酸基、複素環基（好ましくはピリジル基、フリル基、チエニル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、ピラゾリル基、ベンゾフラニル基、モルホリニル基）、ハロゲン（好ましくはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、カルボキシ基、炭素数1～20のアルキルシリル基（好ましくはトリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシリル、ジメチルシリル、ジエチルシリル、ジプロピルシリル、メチルシリル、エチルシリル、プロピルシリル）、または、水素原子である。但し、少なくともひとつのR¹は炭素数1～20のアルキル基であり、また別の少なくともひとつのR¹は水素原子である。

40

【0031】

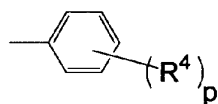
R'は独立して、炭素数2～20のアルキル基（好ましくはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、*t*-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペン

50

チル、ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル、ウンデシル)、又は下記式

【0032】

【化8】



【0033】

で表わされるアリール基である。R⁴は、炭素数1～20のアルキル基（好ましくはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｔｰブチル）、炭素数3～20のシクロアルキル基（好ましくはシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル）、炭素数6～20のアリール基（好ましくはフェニル、ナフチル、アントラニル、フェナントリル）、炭素数1～20のアルコキシ基（好ましくはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、ｔｰブトキシ）、シアノ基、ニトロ基、複素環基（好ましくはピリジル基、フリル基、チエニル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、ピラゾリル基、ベンゾフラニル基、モルホリニル基）、ハロゲン（好ましくはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、カルボキシ基、水酸基、および、炭素数1～20のアルキルシリル基（好ましくはトリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシリル、ジメチルシリル、ジエチルシリル、ジプロピルシリル、メチルシリル、エチルシリル、プロピルシリル）からなる群から選択される官能基である。pは0～5の整数である。

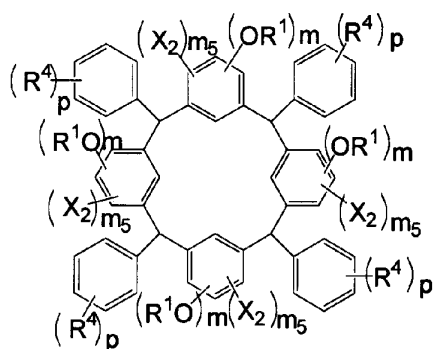
【0034】

mは1～4の整数である。異なるベンゼン環上の－LR¹は同一でも異なってもよく、また、mが2～4の整数である場合、同一ベンゼン環上の2～4個の－LR¹は同一でも異なってもよい。

【0035】

上記式(1)で表される環状化合物は、好ましくは下記式(2)～(7)のいずれかで表される。

【化9】



(式中、R¹、R⁴、p、mは前記と同様である。X₂は水素又はハロゲン原子（好ましくはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素）であり、m₅は0～3の整数であり、m+m₅=4である。)

【0036】

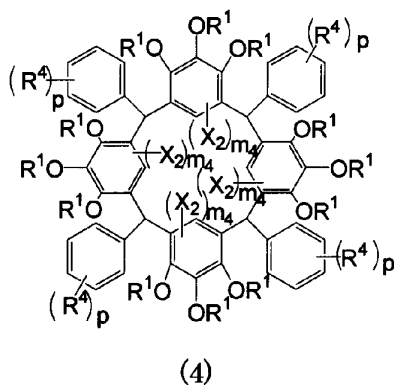
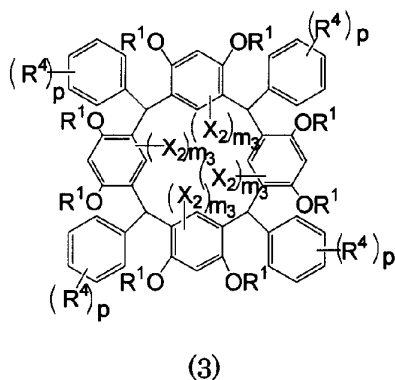
10

20

30

40

【化 1 0】

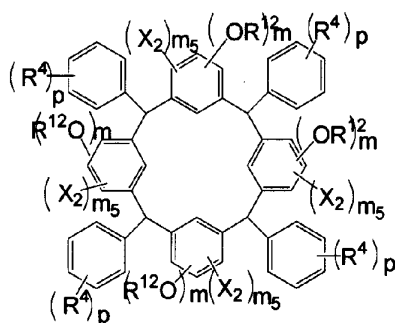


10

(式中、 R^1 、 R^4 、 X_2 、 p は前記と同様である。 m_3 は1～2の整数であり、 m_4 は1である。)

【0 0 3 7】

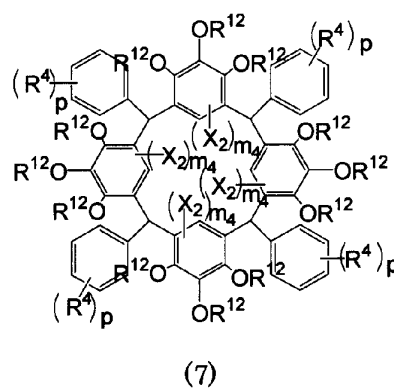
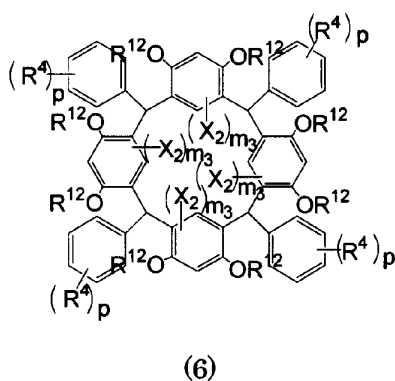
【化 1 1】



20

【0 0 3 8】

【化 1 2】



30

(式中、 R^4 、 X_2 、 p 、 m 、 m_3 、 m_4 、 m_5 は前記のとおりであり、 R^{12} は炭素数1～20のアルキル基または水素原子である。但し、少なくともひとつの R^{12} は炭素数1～20のアルキル基であり、また別の少なくともひとつの R^{12} は水素原子である。)

40

【0 0 3 9】

本発明の環状化合物は耐熱性が高く、アモルファス性を有するため製膜性にも優れ、昇華性を持たず、アルカリ現像性、エッチング耐性等に優れ、レジスト材料、特にレジスト材料の主成分(基材)として好適に用いられる。

また、製造面においても工業的に製造されている芳香族アルデヒドをはじめとする各種アルデヒド類とレゾルシノール、ピロガロール等のフェノール類を原料として、塩酸等の非金属触媒により脱水縮合反応させて得られる前駆体環状化合物と、ハロゲン化アルキル類とを脱ハロゲン化水素反応することにより、高収率で製造できることから、実用性にも

50

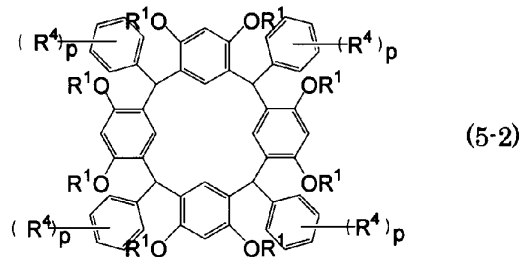
極めて優れる。

【0040】

本発明においては、下記式(5-2)および(5-3)で示される化合物からなる群から選ばれる環状化合物がより好ましい。

【0041】

【化13】

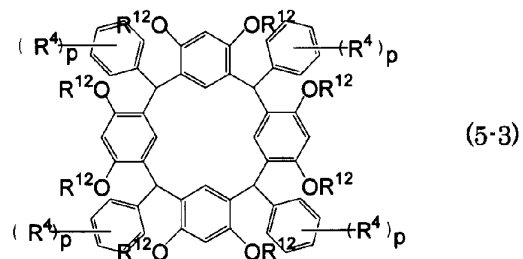


10

(式中、 R^1 、 R^4 、 p は前記と同様である。)

【0042】

【化14】



20

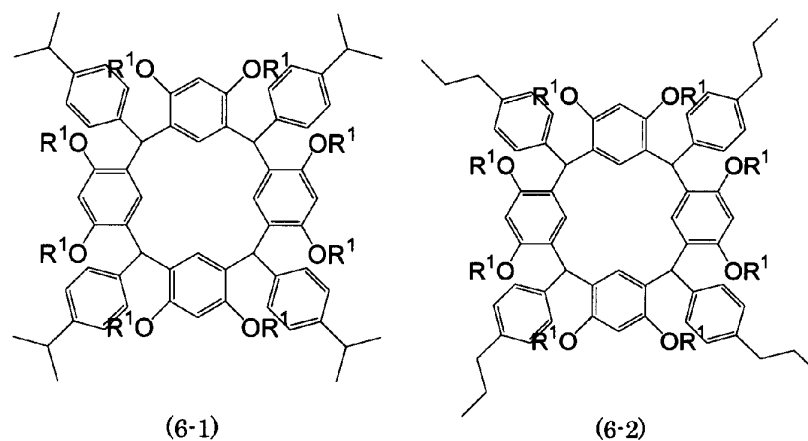
(式中、 R^{12} 、 R^4 、 p は前記と同様である。)

【0043】

本発明においては、下記式(6-1)～(6-8)で示される化合物からなる群から選ばれる環状化合物がさらに好ましい。

【0044】

【化15】

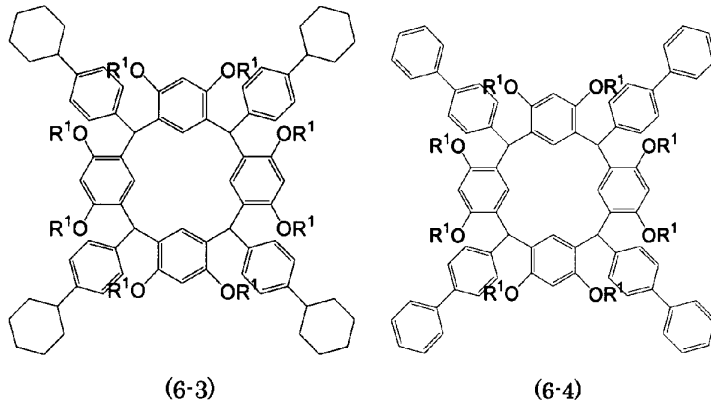


40

(式中、 R^1 は前記と同様である。)

【0045】

【化 1 6】

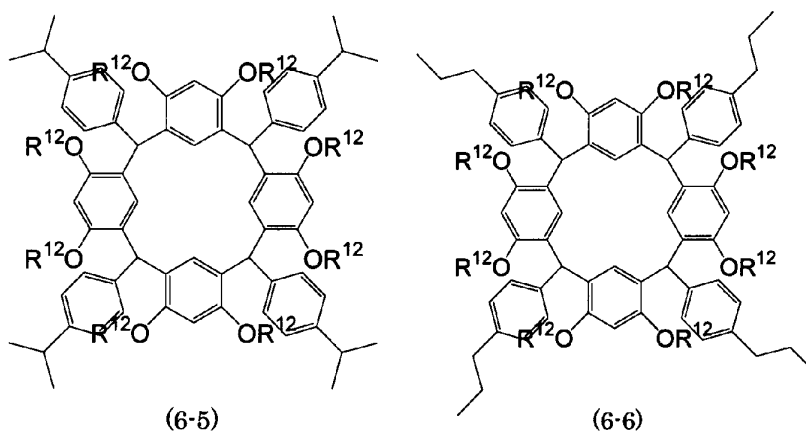


10

(式中、 R^1 は前記と同様である。)

【 0 0 4 6】

【化 1 7】



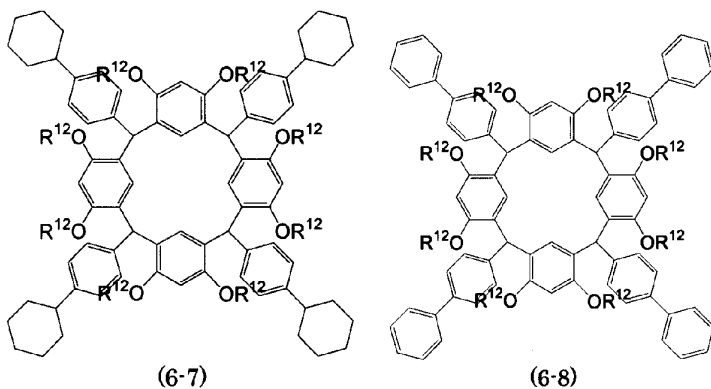
20

(式中、 R^{12} は前記と同様である。)

30

【 0 0 4 7】

【化 1 8】



40

(式中、 R^{12} は前記と同様である。)

【 0 0 4 8】

上記式(6-1)～(6-8)で示される化合物のうち、式(6-7)で示される化合物から選ばれる環状化合物が特に好ましい。式(6-7)で示される化合物は、安全溶媒に対する溶解性が高く、高感度で、かつ、良好な形状のレジストパターンを形成することができる。

【 0 0 4 9】

50

上記式(1)で示される環状化合物の分子量は800～5000であり、好ましくは800～2000、より好ましくは1000～2000である。上記範囲であるとレジストに必要な成膜性を保持しつつ、解像性が向上する。

【0050】

本発明における環状化合物は、シス体およびトランス体を取りうるが、いずれかの構造若しくは混合物でもよい。感放射線性組成物のレジスト成分として用いる場合は、シス体およびトランス体のいずれか一方のみを使用するほうが、レジスト膜中成分の均一性が高いので好ましい。シス体およびトランス体の一方のみからなる環状化合物を得る方法は、カラムクロマトや分取液体クロマトグラフィによる分離や製造時における反応溶媒及び反応温度等の最適化等、公知の方法で行うことができる。

10

【0051】

上記式(1)で示される環状化合物は、アルデヒド性化合物(A1)からなる群より選ばれる1種以上の化合物とフェノール性化合物(A2)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との縮合反応により前駆体環状化合物(以下、環状化合物(A))ということがあ

る)を得、該前駆体環状化合物とハロゲン化アルキル(A3)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との脱ハロゲン化水素反応により得られる。

【0052】

より好ましくは、上記式(1)で示される環状化合物は、芳香族アルデヒド性化合物(A1A)からなる群より選ばれる1種以上の化合物とフェノール性化合物(A2)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との縮合反応により得られる環状化合物(A)と、ハロゲン化アルキル(A3)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との脱ハロゲン化水素反応により得られる。

20

【0053】

また上記式(1)で示される環状化合物は、フェノール性化合物(A2)からなる群より選ばれる1種以上の化合物とハロゲン化アルキル(A3)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との脱ハロゲン化水素反応により得られるフェノール性化合物(A2A)と、アルデヒド性化合物(A1)からなる群より選ばれる1種以上の化合物との縮合反応により得ることもできる。この場合、フェノール性化合物(A2A)の少なくとも1つのフェノール性水酸基を未反応のまま残す必要がある。その反応の制御は困難で、その結果、環状化合物の収率が低下することになるから、好ましい方法ではない。

30

【0054】

アルデヒド性化合物(A1)は炭素数が3～59であり、1～4個のホルミル基を有し、芳香族アルデヒド性化合物(A1A)と脂肪族アルデヒド性化合物(A1B)から選択される。芳香族アルデヒド性化合物(A1A)は炭素数7～24のベンズアルデヒド化合物であるのが好ましく、例えば、ベンズアルデヒド、メチルベンズアルデヒド、ジメチルベンズアルデヒド、エチルベンズアルデヒド、プロピルベンズアルデヒド、ブチルベンズアルデヒド、エチルメチルベンズアルデヒド、イソプロピルメチルベンズアルデヒド、ジエチルベンズアルデヒド、アニスアルデヒド、ナフトアルデヒド、アントラアルデヒド、シクロプロピルベンズアルデヒド、シクロブチルベンズアルデヒド、シクロペンチルベンズアルデヒド、シクロヘキシルベンズアルデヒド、フェニルベンズアルデヒド、ナフチルベンズアルデヒド、アダマンチルベンズアルデヒド、ノルボルニルベンズアルデヒド、ラクチルベンズアルデヒド、イソプロピルベンズアルデヒド、ノルマルプロピルベンズアルデヒド、プロモベンズアルデヒド、ジメチルアミノベンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、ジヒドロキシベンズアルデヒド、トリヒドロキシベンズアルデヒド等が挙げられ、イソプロピルベンズアルデヒド、ノルマルプロピルベンズアルデヒド、シクロヘキシルベンズアルデヒドおよびフェニルベンズアルデヒドが好ましく、シクロヘキシルベンズアルデヒドおよび4-イソプロピルベンズアルデヒドがより好ましい。芳香族アルデヒド性化合物(A1A)は本発明の効果を損ねない範囲で炭素数1～4の直鎖または分岐アルキル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン等を有していても良い。芳香族アルデヒド性化合物(A1A)は、単独で又は二種以上組み合わせて使用してもよい。

40

50

【0055】

脂肪族アルデヒド性化合物（A1B）は炭素数3～24の化合物であるのが好ましく、例えば、プロパナール、イソプロパナール、ブタナール、イソブタナール、t-ブタナール、ペンタナール、イソペンタナール、ネオペンタナール、ヘキサナール、イソヘキサナール、オクタナール、デカナール、ドデカナール、ウンデセナール、シクロプロパンカルボキシアルデヒド、シクロブタンカルボキシアルデヒド、シクロヘキサンカルボキシアルデヒド等が挙げられ、イソブタナール、t-ブタナール、ペンタナール、イソペンタナール、ネオペンタナール、ヘキサナール、イソヘキサナール、オクタナール、デカナール、ドデカナール、シクロプロパンカルボキシアルデヒド、シクロブタンカルボキシアルデヒド、シクロヘキサンカルボキシアルデヒドが好ましく、オクタナール、デカナール、ドデカナール、シクロヘキサンカルボキシアルデヒドがより好ましい。脂肪族アルデヒド性化合物（A1B）は本発明の効果を損ねない範囲でシアノ基、水酸基、ハロゲン等を有していても良い。脂肪族アルデヒド性化合物（A1B）は単独で又は二種以上組み合わせて使用してもよい。

10

【0056】

フェノール性化合物（A2）の炭素数は6～15であるのが好ましく、1～3個のフェノール性水酸基を有することが好ましい。フェノール性化合物（A2）の例としては、フェノール、カテコール、レゾルシノール、ハイドロキノン、ピロガロール等が挙げられ、レゾルシノール、ピロガロールが好ましく、レゾルシノールが更に好ましい。フェノール性化合物（A2）は本発明の効果を損ねない範囲で炭素数1～4の直鎖または分岐アルキル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン等を有していても良い。フェノール性化合物（A2）は、単独で又は二種以上組み合わせて使用してもよい。

20

【0057】

ハロゲン化アルキル（A3）は、炭素数1～20のハロゲン化アルキルであり、その例としては、塩化メチル、臭化メチル、ヨウ化メチル、塩化プロピル、臭化プロピル、ヨウ化プロピル、塩化ブチル、臭化ブチル、ヨウ化ブチル、塩化ヘプチル、臭化ヘプチル、ヨウ化ヘプチル、塩化ヘキシル、臭化ヘキシル、ヨウ化ヘキシル等が挙げられ、塩化メチル、臭化メチル、ヨウ化メチル、塩化プロピル、臭化プロピル、ヨウ化プロピルが好ましく、塩化メチル、臭化メチル、ヨウ化メチルがより好ましく、ヨウ化メチルが更に好ましい。ハロゲン化アルキル（A3）は本発明の効果を損ねない範囲で炭素数1～4の直鎖または分岐アルキル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン等を有していても良い。ハロゲン化アルキル（A3）は、単独で又は二種以上組み合わせて使用してもよい。

30

【0058】

上記式（1）で示される環状化合物は、公知の方法によって製造できる。例えば、メタノール、エタノール等の有機溶媒中、酸触媒（塩酸、硫酸またはパラトルエンスルホン酸等）の存在下で、アルデヒド性化合物（A1）1モルに対し、フェノール性化合物（A2）を0.1～10モルを60～150℃で0.5～20時間程度反応させる。次いで、濾過、メタノール等のアルコール類での洗浄、水洗、濾過による分離後、乾燥させることにより分子量が好ましくは700～5000の環状化合物（A）が得られる。酸触媒の代わりに、塩基性触媒（水酸化ナトリウム、水酸化バリウムまたは1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセン-7等）を使用し、同様に反応することによっても環状化合物（A）は得られる。さらに環状化合物（A）は、上記アルデヒド性化合物（A1）をハロゲン化水素若しくはハロゲンガスでジハロゲン化物とし、単離したジハロゲン化物とフェノール性化合物（A2）とを反応させて製造することも出来る。

40

【0059】

続いて、N-メチル-2-ピロリドン等の有機溶媒中、塩基触媒（トリエチルアミン、アンモニアまたは水酸化ナトリウム等）の存在下で、環状化合物（A）1モルに対し、ハロゲン化アルキル（A3）0.1～10モルを0～150℃で0.5～20時間程度反応させる。この反応により、環状化合物（A）中の少なくとも1つのフェノール性水酸基を変化させることなく、他の少なくとも1つのフェノール性水酸基をアルコキシル基に変換す

50

ることができる。次いで、濾過、メタノール等のアルコール類による洗浄、水洗、濾過による分離後、乾燥させることにより式(1)で示される環状化合物が得られる。

【0060】

得られる環状化合物の半導体安全溶媒に対する溶解性が向上するので、アルデヒド性化合物(A1)、フェノール性化合物(A2)およびハロゲン化アルキル(A3)の少なくともひとつを2種以上用いることがより好ましい。

【0061】

環状化合物中の残存金属量を低減するために、必要に応じて精製してもよい。また酸触媒および助触媒が残存すると、一般に、感放射線性組成物の保存安定性が低下する、または塩基性触媒が残存すると、一般に、感放射線性組成物の感度が低下するので、その低減を目的とした精製を行ってもよい。精製は、環状化合物が変性しない限り公知の方法により行うことができ、特に限定されないが、例えば、水で洗浄する方法、酸性水溶液で洗浄する方法、塩基性水溶液で洗浄する方法、イオン交換樹脂で処理する方法、シリカゲルカラムクロマトグラフィーで処理する方法などが挙げられる。これら精製方法は2種以上を組み合わせる行うことがより好ましい。酸性水溶液、塩基性水溶液、イオン交換樹脂およびシリカゲルカラムクロマトグラフィーは、除去すべき金属、酸性化合物および塩基性化合物の量や種類、精製する環状化合物の種類などに応じて、最適なものを適宜選択することが可能である。例えば、酸性水溶液として、濃度が0.01~10mol/Lの塩酸、硝酸、酢酸水溶液、塩基性水溶液として、濃度が0.01~10mol/Lのアモニア水溶液、イオン交換樹脂として、カチオン交換樹脂、例えばオルガノ製Ambertlyst 15J-HG Dryなどが挙げられる。精製後に乾燥を行っても良い。乾燥は公知の方法により行うことができ、特に限定されないが、環状化合物が変性しない条件で真空乾燥、熱風乾燥する方法などが挙げられる。

【0062】

上記式(1)で示される環状化合物は、スピンコートによりアモルファス膜を形成することができる。また一般的な半導体製造プロセスに適用することができる。

【0063】

上記式(1)で示される環状化合物は、KrFエキシマレーザー、極端紫外線、電子線またはX線を照射することにより、アルカリ現像液に難溶な化合物となるネガ型レジスト用材料として有用である。環状化合物に、KrFエキシマレーザー、極端紫外線、電子線またはX線の照射により、化合物同士の縮合反応が誘起され、アルカリ現像液に難溶な化合物となるためと考えられる。このようにして得られたレジストパターンは、LERが非常に小さい。

【0064】

上記式(1)で示される本発明の環状化合物は、ネガ型感放射線組成物の主成分として用いることができる他、例えば感度向上や耐エッチング耐性を向上するための添加剤として感放射線性組成物に加えることができる。この場合、環状化合物は感放射線性組成物の固形成分全重量の1~49.999重量%用いられる。

【0065】

本発明の環状化合物のガラス転移温度は、好ましくは100℃以上、より好ましくは120℃以上、さらに好ましくは140℃以上、特に好ましくは150℃以上である。ガラス転移温度が上記範囲内であることにより、半導体リソグラフィプロセスにおいて、パターン形状を維持しうる耐熱性を有し、高解像度などの性能が付与しうる。

本発明の環状化合物のガラス転移温度の示差走査熱量分析により求めた結晶化発熱量は20J/g未満であるのが好ましい。また、(結晶化温度)-(ガラス転移温度)は好ましくは70℃以上、より好ましくは80℃以上、さらに好ましくは100℃以上、特に好ましくは130℃以上である。結晶化発熱量が20J/g未満、または(結晶化温度)-(ガラス転移温度)が上記範囲内であると、感放射線性組成物をスピンコートすることにより、アモルファス膜を形成しやすく、かつレジストに必要な成膜性が長期に渡り保持でき、解像性を向上することができる。

【0066】

本発明において、前記結晶化発熱量、結晶化温度およびガラス転移温度は、島津製作所製DSC/TA-50WSを用いた示差走査熱量分析により求めることができる。試料約10mgをアルミニウム製非密封容器に入れ、窒素ガス気流中(50mL/min)昇温速度20℃/minで融点以上まで昇温する。急冷後、再び窒素ガス気流中(30mL/min)昇温速度20℃/minで融点以上まで昇温する。さらに急冷後、再び窒素ガス気流中(30mL/min)昇温速度20℃/minで400℃まで昇温する。ステップ状に変化したベースラインの段差の midpoint (比熱が半分に変化したところ)の温度をガラス転移温度(T_g)、その後に見れる発熱ピークの温度を結晶化温度とする。発熱ピークとベースラインに囲まれた領域の面積から発熱量を求め、結晶化発熱量とする。

10

【0067】

本発明の環状化合物は、常圧下、100℃以下、好ましくは120℃以下、より好ましくは130℃以下、さらに好ましくは140℃以下、特に好ましくは150℃以下において、昇華性が低いことが好ましい。昇華性が低いとは、熱重量分析において、所定温度で10分保持した際の重量減少が10%、好ましくは5%、より好ましくは3%、さらに好ましくは1%、特に好ましくは0.1%以下であることを示す。昇華性が低いことにより、露光時のアウトガスによる露光装置の汚染を防止することができる。また低LERで良好なパターン形状を得ることができる。

【0068】

本発明の環状化合物は、好ましくは $F < 3.0$ (Fは、全原子数/(全炭素原子数-酸素原子数))を表す)、より好ましくは $F < 2.5$ を満たす。上記条件を満たしていることにより、耐ドライエッチング性が優れる。

20

【0069】

本発明の環状化合物は、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)、プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)、シクロヘキサノン(CHN)、シクロペンタノン(CPN)、2-ヘプタノン、アニソール、酢酸ブチル、プロピオン酸エチル、および乳酸エチルから選ばれ、かつ、環状化合物に対して最も高い溶解能を示す溶媒に、23℃で、好ましくは1重量%以上、より好ましくは5重量%以上、さらに好ましくは10重量%以上、特に好ましくは、PGMEA、PGME、CHNから選ばれ、かつ、環状化合物に対して最も高い溶解能を示す溶媒に、23℃で、20重量%以上、特に好ましくはPGMEAに対して、23℃で、20重量%以上溶解する。上記条件を満たしていることにより、実生産における半導体製造工程での使用が可能となる。

30

【0070】

本発明の効果を損ねない範囲で、本発明の環状化合物にハロゲン原子を導入しても良い。前記環状化合物の全構成原子数に対するハロゲン原子数の割合は0.1~60%であることが好ましく、0.1~40%であることがより好ましく、0.1~20%であることがさらに好ましく、0.1~10%であることが特に好ましく、1~5%であることが最も好ましい。上記範囲内であると、放射線に対する感度を上げつつ、成膜性を維持することができる。また安全溶媒溶解性を向上しうる。

【0071】

本発明の効果を損ねない範囲で、本発明の環状化合物に窒素原子を導入しても良い。前記環状化合物の全構成原子数に対する窒素原子数の割合は0.1~40%であることが好ましく、0.1~20%であることがより好ましく、0.1~10%であることがさらに好ましく、0.1~5%であることが特に好ましい。上記範囲内であると、得られるレジストパターンのラインエッジラフネスを減らすことができる。また導入された窒素原子は、二級または三級窒素原子であることが好ましく、三級窒素原子であることがより好ましい。

40

【0072】

本発明の効果を損ねない範囲で、本発明における環状化合物に、可視光線、紫外線、エキシマレーザー、電子線、極端紫外線(EUV)、X線、およびイオンビーム照射あるい

50

はこれにより誘起される化学反応により架橋反応を起こす架橋反応性基を導入してもよい。導入は、例えば、環状化合物と架橋反応性基導入試剤を塩基触媒下で反応させることにより行う。架橋反応性基としては、炭素-炭素多重結合、エポキシ基、アジド基、ハロゲン化フェニル基、およびクロロメチル基が挙げられる。架橋反応性基導入試剤としては、このような架橋反応性基を有する酸、酸塩化物、酸無水物、ジカーボネートなどのカルボン酸誘導体やアルキルハライド等が挙げられる。架橋反応性基を有する環状化合物を含む感放射線性組成物も、高解像度、高耐熱性かつ溶媒可溶性の非高分子系感放射線性組成物として有用である。

【0073】

本発明の効果を損ねない範囲で、本発明の環状化合物の少なくとも1つのフェノール性水酸基に非酸解離性官能基を導入しても良い。非酸解離性官能基とは、酸の存在下で開裂せず、アルカリ可溶性基を生じない特性基をいう。例えば、酸の作用により分解することの無い、C1～20のアルキル基、C3～20のシクロアルキル基、C6～20のアリール基、C1～20のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基、複素環基、ハロゲン、カルボキシ基、C1～20のアルキルシラン、これらの誘導体からなる群から選択される官能基等が挙げられる。

【0074】

本発明の効果を損ねない範囲で、本発明の環状化合物の少なくとも1つのフェノール性水酸基にナフトキノンジアジドエステル基を導入しても良い。環状化合物の少なくとも1つのフェノール性水酸基にナフトキノンジアジドエステル基を導入した環状化合物は、ネガ型感放射線組成物の主成分として使用できる他、ポジ型感放射線組成物の主成分として使用でき、酸発生剤や添加剤として感放射線性組成物に加えることができる。

【0075】

本発明の効果を損ねない範囲で、本発明の環状化合物の少なくとも1つのフェノール性水酸基に、放射線の照射により酸を発生する酸発生性官能基を導入しても良い。環状化合物の少なくとも1つのフェノール性水酸基に、酸発生性官能基を導入した環状化合物は、ネガ型感放射線組成物の主成分として使用できる他、ポジ型感放射線組成物の主成分として使用でき、酸発生剤や添加剤として感放射線性組成物に加えることができる。

【0076】

感放射線性組成物

本発明は、前記した式(1)で示される環状化合物と溶媒とを含む感放射線性組成物に関する。また、本発明は、固形成分1～80重量%および溶媒20～99重量%からなる感放射線性組成物であることが好ましく、さらに、該環状化合物が固形成分全重量の50～99.999重量%であることが好ましい。

【0077】

本発明の感放射線性組成物は、スピコートによりアモルファス膜を形成することができる。本発明の感放射線性組成物をスピコートして形成したアモルファス膜の23℃における2.38質量% TMAH水溶液に対する溶解速度は、 $10 \text{ \AA} / \text{sec}$ 以上が好ましく、 $10 \sim 10000 \text{ \AA} / \text{sec}$ がより好ましく、 $100 \sim 1000 \text{ \AA} / \text{sec}$ がさらに好ましい。 $10 \text{ \AA} / \text{sec}$ 以上であると、アルカリ現像液に溶解し、レジストとすることができる。また $10000 \text{ \AA} / \text{sec}$ 以下の溶解速度を有すると、解像性が向上する場合もある。これは、環状化合物の露光前後の溶解性の変化により、アルカリ現像液に溶解する未露光部と、アルカリ現像液に溶解しない露光部との界面のコントラストが大きくなるからと推測される。またLERの低減、ディフェクトの低減効果がある。

【0078】

本発明の感放射線性組成物をスピコートして形成したアモルファス膜のKrFエキシマレーザー、極端紫外線、電子線またはX線等の放射線により露光した部分の23℃における2.38質量% TMAH水溶液に対する溶解速度は、 $5 \text{ \AA} / \text{sec}$ 以下が好ましく、 $0.05 \sim 5 \text{ \AA} / \text{sec}$ がより好ましく、 $0.0005 \sim 5 \text{ \AA} / \text{sec}$ がさらに好ましい。 $5 \text{ \AA} / \text{sec}$ 以下であるとアルカリ現像液に不溶で、レジストとすることができる。ま

た $0.0005 \text{ Å} / \text{sec}$ 以上の溶解速度を有すると、解像性が向上する場合もある。これは、前記環状化合物のミクロの表面部位が溶解し、LERを低減するからと推測される。またディフェクトの低減効果がある。

【0079】

本発明の感放射線性組成物は、好ましくは固形成分1～80重量%および溶媒20～99重量%であり、より好ましくは固形成分1～50重量%および溶媒50～99重量%、さらに好ましくは固形成分2～40重量%および溶媒60～98重量%であり、特に好ましくは固形成分2～10重量%および溶媒90～98重量%である。

式(1)で示される環状化合物の量は、固形成分全重量(環状化合物、酸発生剤(C)、酸架橋剤(G)、酸拡散制御剤(E)および、その他の成分(F)などの任意に使用される固形成分の総和、以下同様)の50～99.4重量%であり、好ましくは55～90重量%、より好ましくは60～80重量%、特に好ましくは60～70重量%である。上記配合割合であると、高解像度が得られ、ラインエッジラフネスが小さくなる。

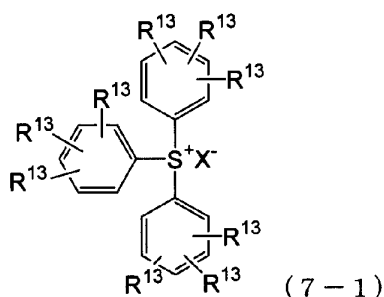
【0080】

本発明の組成物は、可視光線、紫外線、エキシマレーザー、電子線、極端紫外線(EUV)、X線、およびイオンビームから選ばれるいずれかの放射線の照射により直接的又は間接的に酸を発生する酸発生剤(C)を一種以上含むことが好ましい。酸発生剤(C)の使用量は、固形成分全重量の0.001～49重量%が好ましく、1～40重量%がより好ましく、3～30重量%がさらに好ましく、10～25重量%が特に好ましい。上記範囲内で使用することにより、高感度でかつ低エッジラフネスのパターンプロファイルが得られる。本発明では、系内に酸が発生すれば、酸の発生方法は限定されない。g線、i線などの紫外線の代わりにエキシマレーザーを使用すれば、より微細加工が可能であるし、また高エネルギー線として電子線、極端紫外線、X線、イオンビームを使用すれば更に微細加工が可能である。

【0081】

前記酸発生剤(C)としては、下記式(7-1)～(7-8)で表される化合物からなる群から選択される少なくとも一種類であることが好ましい。

【化19】



(式(7-1)中、 R^{13} は、同一でも異なっても良く、それぞれ独立に、水素原子、直鎖状、分枝状もしくは環状アルキル基、直鎖状、分枝状もしくは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基またはハロゲン原子であり； X^- は、アルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基もしくはハロゲン置換アリール基を有するスルホン酸イオンまたはハロゲン化物イオンである。)

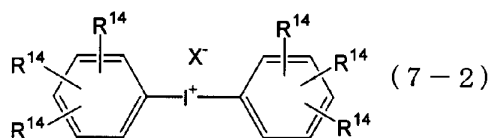
【0082】

前記式(7-1)で示される化合物は、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、ジフェニルトリルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、ジフェニル-4-メチルフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジ-2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニル-4-tert-ブトキシフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニル-4-tert-ブトキシフェニルスルホ

ニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)-フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリ(4-メトキシフェニル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリ(4-フルオロフェニル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム p -トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウムベンゼンスルホネート、ジフェニル-2, 4, 6-トリメチルフェニル- p -トルエンスルホネート、ジフェニル-2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニウム-2-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニル-2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニウム-4-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニル-2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニウム-2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、ジフェニル-2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニウムヘキサフルオロベンゼンスルホネート、ジフェニルナフチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウム- p -トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウム10-カンファースルホネート、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウム10-カンファースルホネートおよびシクロ(1, 3-パーフルオロプロパンジスルホン)イミデートからなる群から選択される少なくとも一種類であることが好ましい。

【0083】

【化20】



(式(7-2)中、 R^{14} は、同一でも異なっても良く、それぞれ独立に、水素原子、直鎖状、分枝状もしくは環状アルキル基、直鎖状、分枝状もしくは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基またはハロゲン原子を表す。 X^- は前記と同様である。)

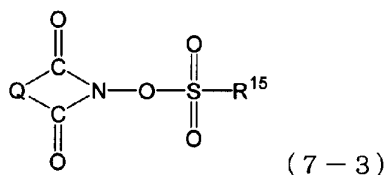
【0084】

前記式(7-2)で示される化合物は、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウム p -トルエンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウムベンゼンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウム-2-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウム-4-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウム-2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウムヘキサフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウム10-カンファースルホネート、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム p -トルエンスルホネート、ジフェニルヨードニウムベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム10-カンファースルホネート、ジフェニルヨードニウム-2-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム-4-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム-2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロベンゼンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)

ヨードニウムパーフルオロ-*n*-オクタンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ヨードニウム *p*-トルエンスルホネート、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ヨードニウムベンゼンスルホネートおよびジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ヨードニウム10-カンファースルホネートからなる群から選択される少なくとも一種類であることが好ましい。

【0085】

【化21】



10

(式(7-3)中、Qはアルキレン基、アリーレン基またはアルコキシレン基であり、R¹⁵はアルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基またはハロゲン置換アリール基である。)

【0086】

前記式(7-3)で示される化合物は、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)フタルイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(*n*-オクタンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(*n*-オクタンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(*p*-トルエンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(*p*-トルエンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(パーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(パーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(1-ナフタレンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(1-ナフタレンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(ノナフルオロ-*n*-ブタンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-*n*-ブタンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(パーフルオロ-*n*-オクタンスルホニルオキシ)ビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミドおよびN-(パーフルオロ-*n*-オクタンスルホニルオキシ)ナフチルイミドからなる群から選択される少なくとも一種類であることが好ましい。

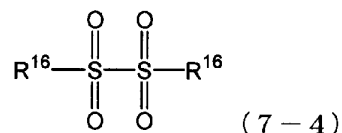
【0087】

20

30

40

【化 2 2】



(式(7-4)中、 R^{16} は、同一でも異なっても良く、それぞれ独立に、任意に置換された直鎖、分枝もしくは環状アルキル基、任意に置換されたアリール基、任意に置換されたヘテロアリール基または任意に置換されたアラルキル基である。)

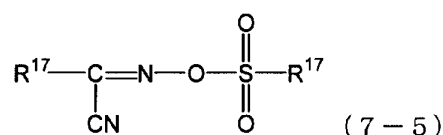
【0088】

10

前記式(7-4)で示される化合物は、ジフェニルジスルホン、ジ(4-メチルフェニル)ジスルホン、ジナフチルジスルホン、ジ(4-tert-ブチルフェニル)ジスルホン、ジ(4-ヒドロキシフェニル)ジスルホン、ジ(3-ヒドロキシナフチル)ジスルホン、ジ(4-フルオロフェニル)ジスルホン、ジ(2-フルオロフェニル)ジスルホンおよびジ(4-トルフルオロメチルフェニル)ジスルホンからなる群から選択される少なくとも一種類であることが好ましい。

【0089】

【化 2 3】



20

(式(7-5)中、 R^{17} は、同一でも異なっても良く、それぞれ独立に、任意に置換された直鎖、分枝もしくは環状アルキル基、任意に置換されたアリール基、任意に置換されたヘテロアリール基または任意に置換されたアラルキル基である。)

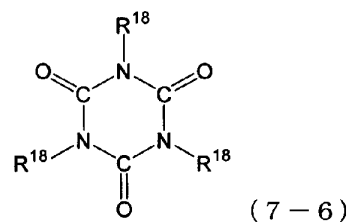
【0090】

前記式(7-5)で示される化合物は、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-フェニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシフェニルアセトニトリル、 α -(トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ)-フェニルアセトニトリル、 α -(トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシフェニルアセトニトリル、 α -(エチルスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシフェニルアセトニトリル、 α -(プロピルスルホニルオキシイミノ)-4-メチルフェニルアセトニトリルおよび α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-4-ブromoフェニルアセトニトリルからなる群から選択される少なくとも一種類であることが好ましい。

30

【0091】

【化 2 4】

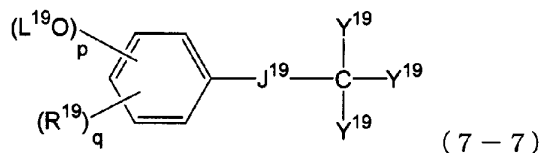


40

式(7-6)中、 R^{18} は、同一でも異なっても良く、それぞれ独立に、1以上の塩素原子および1以上の臭素原子を有するハロゲン化アルキル基である。ハロゲン化アルキル基の炭素原子数は1~5が好ましい。

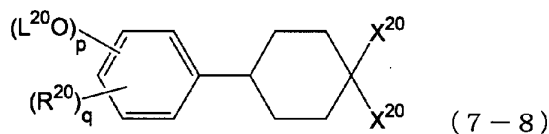
【0092】

【化 2 5】



【0093】

【化 2 6】

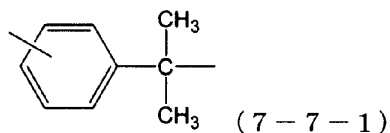


【0094】

式(7-7)および(7-8)中、 R^{19} および R^{20} はそれぞれ独立に、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基等の炭素原子数1~3のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基等の炭素原子数1~3のアルコキシ基、またはフェニル基、トルイル基、ナフチル基等アリール基、好ましくは、炭素原子数6~10のアリール基である。 L^{19} および L^{20} はそれぞれ独立に1, 2-ナフトキノンジアジド基を有する有機基である。1, 2-ナフトキノンジアジド基を有する有機基としては、具体的には、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニル基、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニル基、1, 2-ナフトキノンジアジド-6-スルホニル基等の1, 2-キノンジアジドスルホニル基を好ましいものとして挙げることができる。特に、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニル基および1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニル基が好ましい。 p は1~3の整数、 q は0~4の整数、かつ $1 \leq p + q \leq 5$ である。 J^{19} は単結合、炭素原子数1~4のポリメチレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、下記式(7-7-1)で表わされる基、カルボニル基、エステル基、アミド基またはエーテル基であり、 Y^{19} は水素原子、アルキル基またはアリール基であり、 X^{20} は、それぞれ独立に下記式(7-8-1)で示される基である。

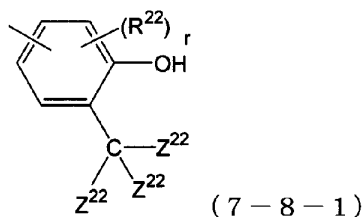
【0095】

【化 2 7】



【0096】

【化 2 8】



(式(7-8-1)中、 Z^{22} はそれぞれ独立に、アルキル基、シクロアルキル基またはアリール基であり、 R^{22} はアルキル基、シクロアルキル基またはアルコキシ基であり、 r は0~3の整数である。)

【0097】

その他の酸発生剤として、ビス（p-トルエンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（2, 4-ジメチルフェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（tert-ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（n-ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（n-プロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（シクロヘキシルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、1, 3-ビス（シクロヘキシルスルホニルアゾメチルスルホニル）プロパン、1, 4-ビス（フェニルスルホニルアゾメチルスルホニル）ブタン、1, 6-ビス（フェニルスルホニルアゾメチルスルホニル）ヘキサン、1, 10-ビス（シクロヘキシルスルホニルアゾメチルスルホニル）デカンなどのビススルホニルジアゾメタン類、2-（4-メトキシフェニル）-4, 6-（ビストリクロロメチル）-1, 3, 5-トリアジン、2-（4-メトキシナフチル）-4, 6-（ビストリクロロメチル）-1, 3, 5-トリアジン、トリス（2, 3-ジブロモプロピル）-1, 3, 5-トリアジン、トリス（2, 3-ジブロモプロピル）イソシアヌレートなどのハロゲン含有トリアジン誘導体等が挙げられる。

10

【0098】

上記酸発生剤のうち、芳香環を有する酸発生剤が好ましく、式（7-1）または（7-2）で示され酸発生剤がより好ましい。式（7-1）または（7-2）のX⁻が、アリール基もしくはハロゲン置換アリール基を有するスルホン酸イオンを有する酸発生剤がさらに好ましく、アリール基を有するスルホン酸イオンを有する酸発生剤が特に好ましく、ジフェニルトリメチルフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム ノナフルオロメタンスルホネートが特に好ましい。該酸発生剤を用いることで、LERを低減することができる。

20

上記酸発生剤（C）は、単独で、または2種以上を使用することができる。

【0099】

本発明の感放射線性組成物は、酸架橋剤（G）を一種以上含むことが好ましい。酸架橋剤（G）とは、酸発生剤（C）から発生した酸の存在下で、式（1）の環状化合物を分子内又は分子間架橋し得る化合物である。このような酸架橋剤（G）としては、例えば式（1）の環状化合物を架橋し得る1種以上の基（以下、「架橋性基」という。）を有する化合物を挙げることができる。

30

【0100】

このような架橋性基の具体例としては、例えば（i）ヒドロキシ（C1-C6アルキル基）、C1-C6アルコキシ（C1-C6アルキル基）、アセトキシ（C1-C6アルキル基）等のヒドロキシアルキル基またはそれらから誘導される基；（ii）ホルミル基、カルボキシ（C1-C6アルキル基）等のカルボニル基またはそれらから誘導される基；（iii）ジメチルアミノメチル基、ジエチルアミノメチル基、ジメチロールアミノメチル基、ジエチロールアミノメチル基、モルホリノメチル基等の含窒素基含有基；（iv）グリシジルエーテル基、グリシジルエステル基、グリシジルアミノ基等のグリシジル基含有基；（v）ベンジルオキシメチル基、ベンゾイルオキシメチル基等の、C1-C6アリルオキシ（C1-C6アルキル基）、C1-C6アラルキルオキシ（C1-C6アルキル基）等の芳香族基から誘導される基；（vi）ビニル基、イソプロペニル基等の重合性多重結合含有基等を挙げることができる。本発明の酸架橋剤（G）の架橋性基としては、ヒドロキシアルキル基、およびアルコキシアルキル基等が好ましく、特にアルコキシメチル基が好ましい。

40

【0101】

前記架橋性基を有する酸架橋剤（G）としては、例えば（i）メチロール基含有メラミン化合物、メチロール基含有ベンゾグアナミン化合物、メチロール基含有ウレア化合物、メチロール基含有グリコールウリル化合物、メチロール基含有フェノール化合物等のメチロール基含有化合物；（ii）アルコキシアルキル基含有メラミン化合物、アルコキシアル

50

キル基含有ベンゾグアナミン化合物、アルコシアルキル基含有ウレア化合物、アルコシアルキル基含有グリコールウリル化合物、アルコシアルキル基含有フェノール化合物等のアルコシアルキル基含有化合物；(iii)カルボキシメチル基含有メラミン化合物、カルボキシメチル基含有ベンゾグアナミン化合物、カルボキシメチル基含有ウレア化合物、カルボキシメチル基含有グリコールウリル化合物、カルボキシメチル基含有フェノール化合物等のカルボキシメチル基含有化合物；(iv)ビスフェノールA系エポキシ化合物、ビスフェノールF系エポキシ化合物、ビスフェノールS系エポキシ化合物、ノボラック樹脂系エポキシ化合物、レゾール樹脂系エポキシ化合物、ポリ(ヒドロキシスチレン)系エポキシ化合物等のエポキシ化合物等を挙げることができる。

【0102】

10

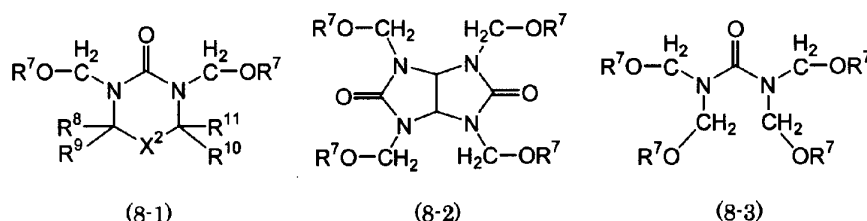
酸架橋剤(G)としては、さらに、フェノール性水酸基を有する化合物、ならびにアルカリ可溶性樹脂中の酸性官能基に前記架橋性基を導入し、架橋性を付与した化合物および樹脂を使用することができる。その場合の架橋性基の導入率は、フェノール性水酸基を有する化合物、およびアルカリ可溶性樹脂中の全酸性官能基に対して、通常、5～100モル%、好ましくは10～60モル%、さらに好ましくは15～40モル%に調節される。上記範囲であると、架橋反応が十分起こり、残膜率の低下、パターンの膨潤現象や蛇行等が避けられるので好ましい。

本発明の感放射線性組成物において酸架橋剤(G)は、アルコシアルキル化ウレア化合物もしくはその樹脂、またはアルコシアルキル化グリコールウリル化合物もしくはその樹脂が好ましい。特に好ましい酸架橋剤(G)としては、下記式(8-1)～(8-3)で示される化合物及びアルコキシメチル化メラミン化合物を挙げることができる(酸架橋剤(G1))。

20

【0103】

【化29】



30

(上記式(8)中、R⁷はそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、またはアシル基を表し；R⁸～R¹¹はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、アルキル基、またはアルコキシ基を示し；X²は、単結合、メチレン基、または酸素原子を示す。)

【0104】

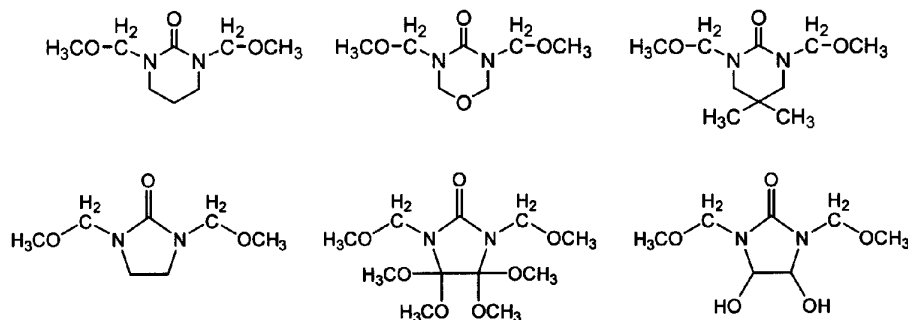
R⁷が表すアルキル基は、炭素数1～6が好ましく、炭素数1～3がより好ましく、例えばメチル基、エチル基、プロピル基が挙げられる。R⁷が表すアシル基は、炭素数2～6が好ましく、炭素数2～4がより好ましく、例えばアセチル基、プロピオニル基が挙げられる。R⁸～R¹¹が表すアルキル基は、炭素数1～6が好ましく、炭素数1～3がより好ましく、例えばメチル基、エチル基、プロピル基が挙げられる。R⁸～R¹¹が表すアルコキシ基は、炭素数1～6が好ましく、炭素数1～3がより好ましく、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基が挙げられる。X²は単結合又はメチレン基であるのが好ましい。R⁷～R¹¹、X²は、メチル基、エチル基等のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子などで置換されていてもよい。複数個のR⁷、R⁸～R¹¹は、各々同一でも異なってもよい。

40

【0105】

式(8-1)で表される化合物として具体的には、例えば、以下に示される化合物等を挙げることができる。

【化 3 0】



10

【0106】

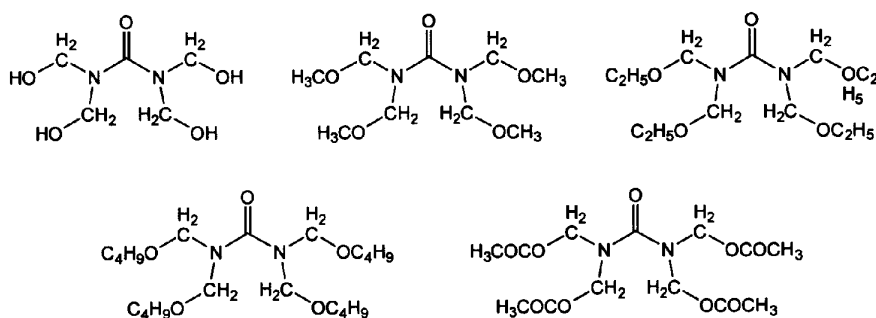
式(8-2)で表される化合物として具体的には、例えば、N, N, N, N-テトラ(メトキシメチル)グリコールウリル、N, N, N, N-テトラ(エトキシメチル)グリコールウリル、N, N, N, N-テトラ(n-プロポキシメチル)グリコールウリル、N, N, N, N-テトラ(イソプロポキシメチル)グリコールウリル、N, N, N, N-テトラ(n-ブトキシメチル)グリコールウリル、N, N, N, N-テトラ(t-ブトキシメチル)グリコールウリル等を挙げることができる。この中で、特に、N, N, N, N-テトラ(メトキシメチル)グリコールウリルが好ましい。

20

【0107】

式(8-3)で表される化合物として具体的には、例えば、以下に示される化合物等を挙げることができる。

【化 3 1】



30

【0108】

アルコキシメチル化メラミン化合物として具体的には、例えば、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(メトキシメチル)メラミン、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(エトキシメチル)メラミン、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(n-プロポキシメチル)メラミン、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(イソプロポキシメチル)メラミン、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(n-ブトキシメチル)メラミン、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(t-ブトキシメチル)メラミン等を挙げることができる。この中で特に、N, N, N, N, N, N-ヘキサ(メトキシメチル)メラミンが好ましい。

40

前記酸架橋剤(G1)は、例えば尿素化合物またはグリコールウリル化合物、およびホルマリンを縮合反応させてメチロール基を導入した後、さらにメチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコール等の低級アルコール類でエーテル化し、次いで反応液を冷却して析出する化合物またはその樹脂を回収することで得られる。また前記酸架橋剤(G1)は、CYMEL(商品名、三井サイアナミッド製)、ニカラック(三和ケミカル(株)製)のような市販品としても入手することができる。

【0109】

また、他の特に好ましい酸架橋剤(G)として、分子内にベンゼン環を1~6有し、ヒ

50

ドロキシアルキル基及び／又はアルコキシアルキル基を分子内全体に2以上有し、該ヒドロキシアルキル基及び／又はアルコキシアルキル基が前記いずれかのベンゼン環に結合しているフェノール誘導体を挙げることができる（酸架橋剤（G2））。好ましくは、分子量が1500以下、分子内にベンゼン環を1～6有し、ヒドロキシアルキル基及び／又はアルコキシアルキル基を合わせて2以上有し、該ヒドロキシアルキル基及び／又はアルコキシアルキル基が前記ベンゼン環のいずれか一、または、複数のベンゼン環に結合してなるフェノール誘導体を挙げることができる。

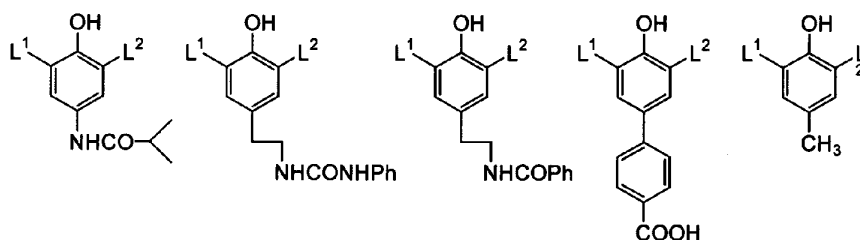
【0110】

ベンゼン環に結合するヒドロキシアルキル基としては、ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基、及び2-ヒドロキシ-1-プロピル基などの炭素数1～6のものが好ましい。ベンゼン環に結合するアルコキシアルキル基としては、炭素数2～6のものが好ましい。具体的にはメトキシメチル基、エトキシメチル基、n-プロポキシメチル基、イソプロポキシメチル基、n-ブトキシメチル基、イソブトキシメチル基、sec-ブトキシメチル基、tert-ブトキシメチル基、2-メトキシエチル基、及び、2-メトキシ-1-プロピル基が好ましい。

【0111】

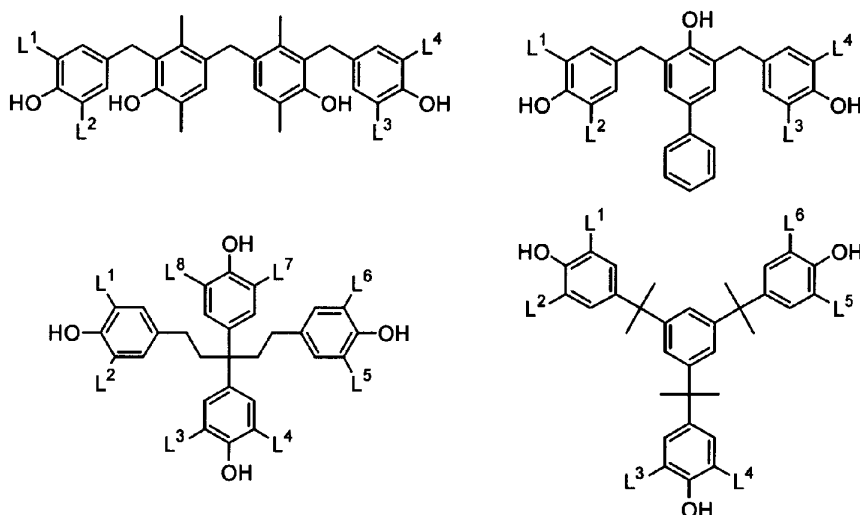
これらのフェノール誘導体のうち、特に好ましいものを以下に挙げる。

【化32】



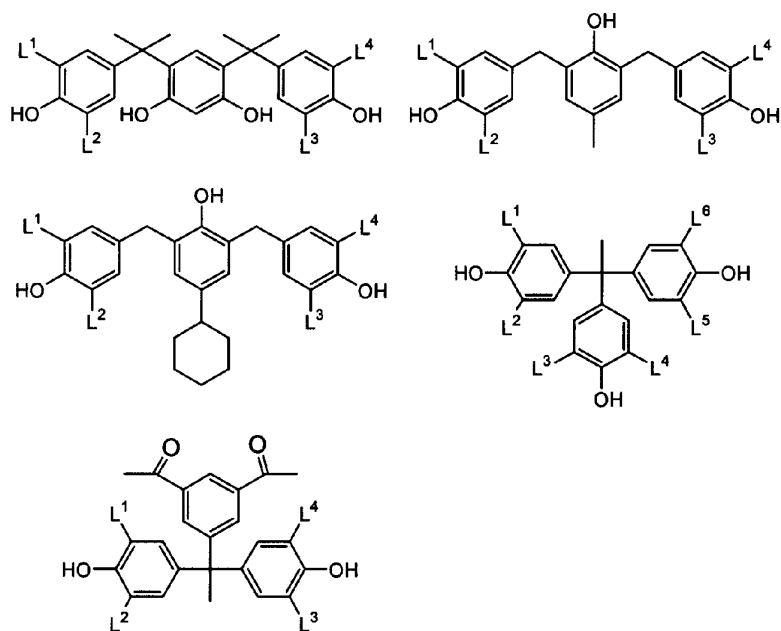
【0112】

【化33】



【0113】

【化 3 4】

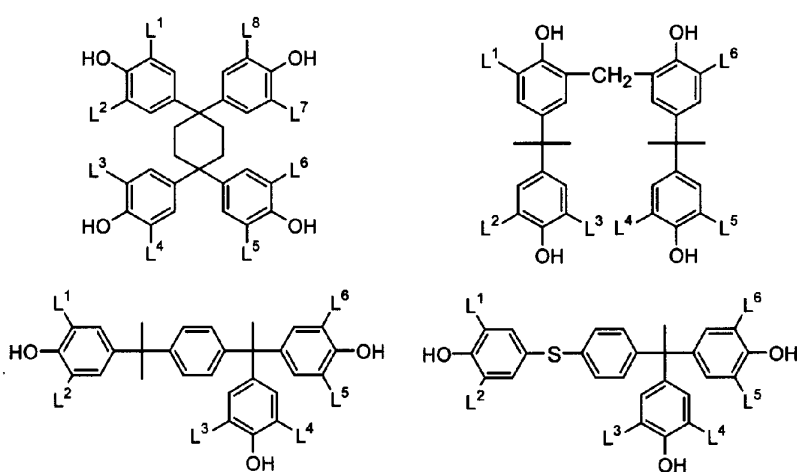


10

【 0 1 1 4】

20

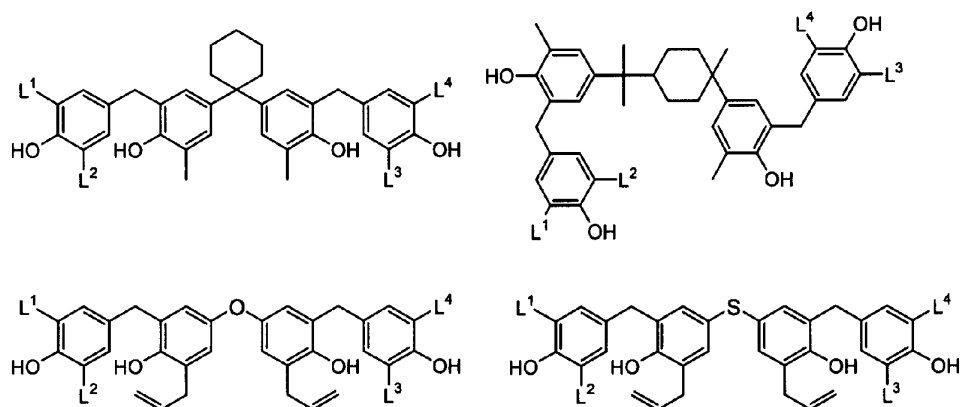
【化 3 5】



30

【 0 1 1 5】

【化 3 6】

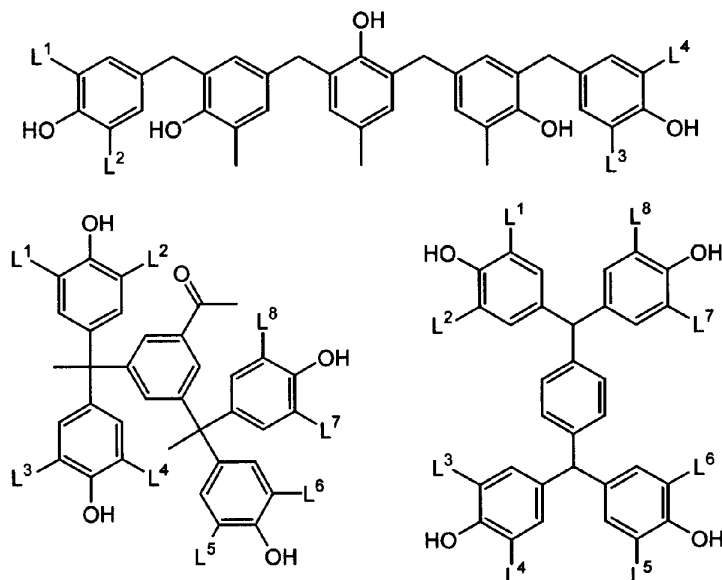


40

【 0 1 1 6】

50

【化 3 7】



10

【0117】

上記式中、 $L^1 \sim L^8$ は、同じであっても異なってもよく、それぞれ独立して、ヒドロキシメチル基、メトキシメチル基又はエトキシメチル基を示す。ヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有さないフェノール化合物（上記式において $L^1 \sim L^8$ が水素原子である化合物）とホルムアルデヒドを塩基触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を 60°C 以下で行うことが好ましい。具体的には、特開平6-282067号公報、特開平7-64285号公報等に記載されている方法にて合成することができる。

20

アルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体とアルコールを酸触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を 100°C 以下で行うことが好ましい。具体的には、EP632003A1等に記載されている方法にて合成することができる。

30

【0118】

このようにして合成されたヒドロキシメチル基及び／又はアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、保存時の安定性の点で好ましいが、アルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は保存時の安定性の観点から特に好ましい。酸架橋剤（G2）は、単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせ使用してもよい。

【0119】

また、他の特に好ましい酸架橋剤（G）として、少なくとも一つの α -ヒドロキシイソプロピル基を有する化合物を挙げることができる（酸架橋剤（G3））。 α -ヒドロキシイソプロピル基を有する限り、その構造に特に限定はない。また、上記 α -ヒドロキシイソプロピル基中のヒドロキシル基の水素原子を1種以上の酸解離性基（ $R-COO-$ 基、 $R-SO_2-$ 基等、 R は、炭素数1~12の直鎖状炭化水素基、炭素数3~12の環状炭化水素基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数3~12の1-分岐アルキル基、および炭素数6~12の芳香族炭化水素基からなる群から選ばれる置換基を表す）で置換されていてもよい。上記 α -ヒドロキシイソプロピル基を有する化合物としては、例えば、少なくとも1つの α -ヒドロキシイソプロピル基を含有する置換又は非置換の芳香族系化合物、ジフェニル化合物、ナフタレン化合物、フラン化合物等の1種又は2種以上が挙げられる。具体的には、例えば、下記一般式（9-1）で表される化合物（以下、「ベンゼン系化合物（1）」という。）、下記一般式（9-2）で表される化合物（以下、「ジフェニル系化合物（2）」という。）、下記一般式（9-3）で表される化合物（以下、「ナ

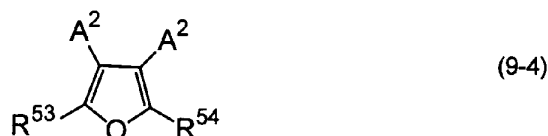
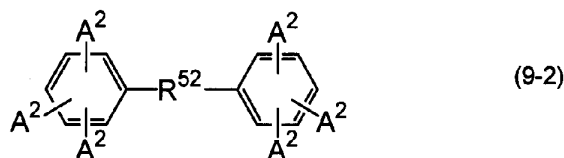
40

50

フタレン系化合物（３」という。）及び下記一般式（９－４）で表される化合物（以下、「フラン系化合物（４）」という。）等が挙げられる。

【０１２０】

【化３８】



【０１２１】

上記一般式（９－１）～（９－４）中、各 A^2 は独立に α -ヒドロキシイソプロピル基又は水素原子を示し、かつ少なくとも１の A^2 が α -ヒドロキシイソプロピル基である。また、一般式（９－１）中、 R^{51} は水素原子、ヒドロキシル基、炭素数２～６の直鎖状若しくは分岐状のアルキルカルボニル基、又は炭素数２～６の直鎖状若しくは分岐状のアルコキシカルボニル基を示す。更に、一般式（９－２）中、 R^{52} は単結合、炭素数１～５の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、又は $-COO-$ を示す。また、一般式（９－４）中、 R^{53} 及び R^{54} は、相互に独立に水素原子又は炭素数１～６の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を示す。

【０１２２】

上記ベンゼン系化合物（１）として具体的には、例えば、 α -ヒドロキシイソプロピルベンゼン、１，３-ビス（ α -ヒドロキシイソプロピル）ベンゼン、１，４-ビス（ α -ヒドロキシイソプロピル）ベンゼン、１，２，４-トリス（ α -ヒドロキシイソプロピル）ベンゼン、１，３，５-トリス（ α -ヒドロキシイソプロピル）ベンゼン等の α -ヒドロキシイソプロピルベンゼン類；３- α -ヒドロキシイソプロピルフェノール、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェノール、３，５-ビス（ α -ヒドロキシイソプロピル）フェノール、２，４，６-トリス（ α -ヒドロキシイソプロピル）フェノール等の α -ヒドロキシイソプロピルフェノール類；３- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・メチルケトン、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・メチルケトン、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・エチルケトン、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・ n -プロピルケトン、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・イソプロピルケトン、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・ n -ブチルケトン、４- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・ n -ペンチルケトン、３，５-ビス（ α -ヒドロキシイソプロピル）フェニル・メチルケトン、３，５-ビス（ α -ヒドロキシイソプロピル）フェニル・エチルケトン、２，４，６-トリス（ α -ヒドロキシイソプロピル）フェニル・メチルケトン等の α -ヒドロキシイソプロピルフェニル・アルキルケトン類；３- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸メチル、４- α

【 0 1 2 3 】

50

キシイソプロピル) ジフェニルエーテル、3, 3', 5, 5'-テトラキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルエーテル、2, 3', 4, 5', 6-ペンタキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルエーテル、2, 2', 4, 4', 6, 6'-ヘキサキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルエーテル等の α -ヒドロキシイソプロピルジフェニルエーテル類; 3- α -ヒドロキシイソプロピルジフェニルケトン、4- α -ヒドロキシイソプロピルジフェニルケトン、3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、3, 3'-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、3, 4'-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、4, 4'-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、3, 3', 5-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、3, 4', 5-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、2, 3', 4, 6-テトラキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、2, 4, 4', 6-テトラキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、3, 3', 5, 5'-テトラキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、2, 3', 4, 5', 6-ペンタキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン、2, 2', 4, 4', 6, 6'-ヘキサキス (α -ヒドロキシイソプロピル) ジフェニルケトン等の α -ヒドロキシイソプロピルジフェニルケトン類; 3- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸フェニル、4- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸フェニル、安息香酸 3- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、安息香酸 4- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸フェニル、3- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 3- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、3- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 4- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、4- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 3- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、4- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 4- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、安息香酸 3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸フェニル、3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 3- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 4- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、3- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、4- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、安息香酸 2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 3- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 4- α -ヒドロキシイソプロピルフェニル、3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、3- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、4- α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸 2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、3, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル、2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) 安息香酸 2, 4, 6-トリス (α -ヒドロキシイソプロピル) フェニル等の α -ヒドロキシイソプロピル安息香酸フェニル類等が挙げられる。

【0124】

更に、上記ナフタレン系化合物 (3) として具体的には、例えば、1- (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、2- (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、1, 3-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、1, 4-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、1, 5-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、1, 6-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、1, 7-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、2, 6-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、2, 7-ビス (α -ヒドロキシイソプロピル) ナフタレン、1, 3, 5-トリス (α -ヒド

10

20

30

40

50

ロキシイソプロピル)ナフタレン、1, 3, 6-トリス(α-ヒドロキシイソプロピル)ナフタレン、1, 3, 7-トリス(α-ヒドロキシイソプロピル)ナフタレン、1, 4, 6-トリス(α-ヒドロキシイソプロピル)ナフタレン、1, 4, 7-トリス(α-ヒドロキシイソプロピル)ナフタレン、1, 3, 5, 7-テトラキス(α-ヒドロキシイソプロピル)ナフタレン等が挙げられる。

【0125】

また、上記フラン系化合物(4)として具体的には、例えば、3-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-メチル-3-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-メチル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-エチル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-n-プロピル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-イソプロピル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-n-ブチル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-t-ブチル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2-n-ペンチル-4-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2, 5-ジメチル-3-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2, 5-ジエチル-3-(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、3, 4-ビス(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2, 5-ジメチル-3, 4-ビス(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン、2, 5-ジエチル-3, 4-ビス(α-ヒドロキシイソプロピル)フラン等を挙げることができる。

【0126】

上記酸架橋剤(G3)としては、遊離のα-ヒドロキシイソプロピル基を2以上有する化合物が好ましく、α-ヒドロキシイソプロピル基を2以上有する前記ベンゼン系化合物(1)、α-ヒドロキシイソプロピル基を2以上有する前記ジフェニル系化合物(2)、α-ヒドロキシイソプロピル基を2個以上有する前記ナフタレン系化合物(3)が更に好ましく、α-ヒドロキシイソプロピル基を2個以上有するα-ヒドロキシイソプロピルビフェニル類、α-ヒドロキシイソプロピル基を2個以上有するナフタレン系化合物(3)が特に好ましい。

上記酸架橋剤(G3)は、通常、1, 3-ジアセチルベンゼン等のアセチル基含有化合物に、 CH_3MgBr 等のグリニヤール試薬を反応させてメチル化した後、加水分解する方法や、1, 3-ジイソプロピルベンゼン等のイソプロピル基含有化合物を酸素等で酸化して過酸化物を生成させた後、還元する方法により得ることができる。

【0127】

本発明において酸架橋剤(G)の使用量は、固形成分全重量の0.5~49重量%が好ましく、0.5~40重量%がより好ましく、1~30重量%がさらに好ましく、2~20重量%が特に好ましい。上記酸架橋剤(G)の配合割合を0.5重量%以上とすると、レジスト膜のアルカリ現像液に対する溶解性の抑制効果を向上させ、残膜率が低下したり、パターンの膨潤や蛇行が生じたりするのを抑制することができるので好ましく、一方、50重量%以下とすると、レジストとしての耐熱性の低下を抑制できることから好ましい。

【0128】

また、上記酸架橋剤(G)中の上記酸架橋剤(G1)、酸架橋剤(G2)、酸架橋剤(G3)から選ばれる少なくとも1種の化合物の配合割合も特に限定はなく、レジストパターンを形成する際に使用される基板の種類等によって種々の範囲とすることができる。

全酸架橋剤成分において、上記アルコキシメチル化メラミン化合物及び/又は(9-1)~(9-3)で示される化合物が50~99重量%、好ましくは60~99重量%、より好ましくは70~98重量%、更に好ましくは80~97重量%であることが好ましい。アルコキシメチル化メラミン化合物及び/又は(9-1)~(9-3)で示される化合物を全酸架橋剤成分の50重量%以上とすることにより、解像度を向上させることができるので好ましく、99重量%以下とすることにより、パターン断面形状として矩形状の断面形状とし易いので好ましい。

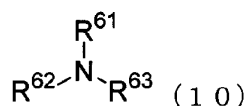
【0129】

本発明においては、放射線照射により酸発生剤から生じた酸のレジスト膜中における拡散を制御して、未露光領域での好ましくない化学反応を阻止する作用等を有する酸拡散制御剤（E）を感放射線性組成物に配合しても良い。この様な酸拡散制御剤（E）を使用することにより、感放射線性組成物の貯蔵安定性が向上する。また解像度が向上するとともに、放射線照射前の引き置き時間、放射線照射後の引き置き時間の変動によるレジストパターン線の幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れたものとなる。このような酸拡散制御剤（E）としては、窒素原子含有塩基性化合物、塩基性スルホニウム化合物、塩基性ヨードニウム化合物等の電子線放射分解性塩基性化合物が挙げられる。酸拡散制御剤（E）は、単独でまたは2種以上を使用することができる。

上記酸拡散制御剤としては、例えば、含窒素有機化合物や、露光により分解する塩基性化合物等が挙げられる。上記含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式（10）：

【0130】

【化39】



で表される化合物（以下、「含窒素化合物（I）」という。）、同一分子内に窒素原子を2個有するジアミノ化合物（以下、「含窒素化合物（II）」という。）、窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体（以下、「含窒素化合物（III）」という。）、アミド基含有化合物、ウレア化合物、及び含窒素複素環式化合物等を挙げることができる。尚、酸拡散制御剤（E）は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0131】

上記一般式（10）中、 R^{61} 、 R^{62} 及び R^{63} は相互に独立に水素原子、直鎖状、分岐状若しくは環状のアルキル基、アリール基、又はアラルキル基を示す。また、上記アルキル基、アリール基、又はアラルキル基は、非置換でもよく、ヒドロキシル基等で置換されていてもよい。ここで、上記直鎖状、分岐状若しくは環状のアルキル基としては、例えば、炭素数1～15、好ましくは1～10のものが挙げられ、具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、*n*-ペンチル基、ネオペンチル基、*n*-ヘキシル基、テキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-エチルヘキシル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。また、上記アリール基としては、炭素数6～12のものが挙げられ、具体的には、フェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、1-ナフチル基等が挙げられる。更に、上記アラルキル基としては、炭素数7～19、好ましくは7～13のものが挙げられ、具体的には、ベンジル基、 α -メチルベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等が挙げられる。

【0132】

上記含窒素化合物（I）として具体的には、例えば、*n*-ヘキシルアミン、*n*-ヘプチルアミン、*n*-オクチルアミン、*n*-ノニルアミン、*n*-デシルアミン、*n*-ドデシルアミン、シクロヘキシルアミン等のモノ（シクロ）アルキルアミン類；ジ-*n*-ブチルアミン、ジ-*n*-ペンチルアミン、ジ-*n*-ヘキシルアミン、ジ-*n*-ヘプチルアミン、ジ-*n*-オクチルアミン、ジ-*n*-ノニルアミン、ジ-*n*-デシルアミン、メチル-*n*-ドデシルアミン、ジ-*n*-ドデシルメチル、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジ（シクロ）アルキルアミン類；トリエチルアミン、トリ-*n*-プロピルアミン、トリ-*n*-ブチルアミン、トリ-*n*-ペンチルアミン、トリ-*n*-ヘキシルアミン、トリ-*n*-ヘプチルアミン、トリ-*n*-オクチルアミン、トリ-*n*-ノニルアミン、トリ-*n*-デシルアミン、ジメチル-*n*-ドデシルアミン、ジ-*n*-ドデシルメチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ（シクロ）アルキルアミン類；モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルカノールアミン類；アニリン、*N*-メチルアニリン、*N,N*-ジメチルアニリン、2-メ

10

20

30

40

50

チルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニトロアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、1-ナフチルアミン等の芳香族アミン類等を挙げることができる。

【0133】

上記含窒素化合物(II)として具体的には、例えば、エチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジアミノベンゾフェノン、4, 4'-ジアミノジフェニルアミン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1, 4-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼン、1, 3-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼン等を挙げることができる。

10

【0134】

上記含窒素化合物(III)として具体的には、例えば、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、N-(2-ジメチルアミノエチル)アクリルアミドの重合体等を挙げることができる。

上記アミド基含有化合物として具体的には、例えば、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、N-メチルピロリドン等を挙げることができる。

20

【0135】

上記ウレア化合物として具体的には、例えば、尿素、メチルウレア、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア、1, 1, 3, 3-テトラメチルウレア、1, 3-ジフェニルウレア、トリ-n-ブチルチオウレア等を挙げることができる。

【0136】

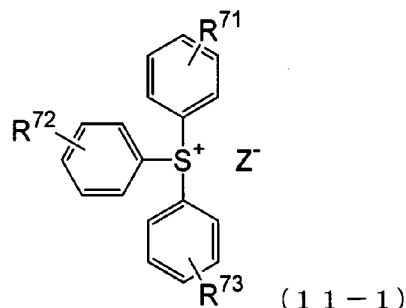
上記含窒素複素環式化合物として具体的には、例えば、イミダゾール、ベンズイミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール、2-フェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類；ピリジン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチルピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジン、2-メチル-4-フェニルピリジン、ニコチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のピリジン類；及び、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、4-メチルモルホリン、ピペラジン、1, 4-ジメチルピペラジン、1, 4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン等を挙げることができる。

30

【0137】

また、上記放射線分解性塩基性化合物としては、例えば、下記一般式(11-1)：

【化40】



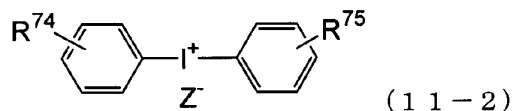
40

で表されるスルホニウム化合物、及び下記一般式(11-2)：

【0138】

50

【化 4 1】



で表されるヨードニウム化合物等を挙げることができる。

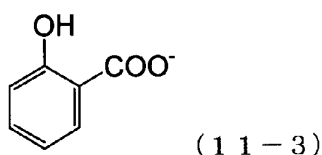
【0139】

上記一般式 (11-1) 及び (11-2) 中、 R^{71} 、 R^{72} 、 R^{73} 、 R^{74} 及び R^{75} は相互に独立に水素原子、炭素数 1～6 のアルキル基、炭素数 1～6 のアルコキシ基、ヒドロキシ基又はハロゲン原子を示す。 Z^- は HO^- 、 $R-COO^-$ (但し、 R は炭素数 1～6 のアルキル基、炭素数 6～11 のアリール基若しくは炭素数 7～12 のアルカリール基を示す。) 又は下記一般式 (11-3) :

10

【0140】

【化 4 2】



で表されるアニオンを示す。

20

【0141】

上記放射線分解性塩基性化合物として具体的には、例えば、トリフェニルスルホニウムヒドロオキシド、トリフェニルスルホニウムアセテート、トリフェニルスルホニウムサリチレート、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムヒドロオキシド、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムアセテート、ジフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムサリチレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムヒドロオキシド、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムアセテート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムヒドロオキシド、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムアセテート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムサリチレート、4-tert-ブチルフェニル-4-ヒドロキシフェニルヨードニウムヒドロオキシド、4-tert-ブチルフェニル-4-ヒドロキシフェニルヨードニウムアセテート、4-tert-ブチルフェニル-4-ヒドロキシフェニルヨードニウムサリチレート等が挙げられる。

30

【0142】

酸拡散制御剤 (E) の配合量は、固形成分全重量の 0.001～49 重量% が好ましく、0.01～10 重量% がより好ましく、0.01～5 重量% がさらに好ましく、0.01～3 重量% が特に好ましい。上記範囲内であると、解像度の低下、パターン形状、寸法忠実度等の劣化を防止することができる。さらに、電子線照射から放射線照射後加熱までの引き置き時間が長くなっても、パターン上層部の形状が劣化することがない。また、配合量が 10 重量% 以下であると、感度、未露光部の現像性等の低下を防ぐことができる。またこの様な酸拡散制御剤を使用することにより、感放射線性組成物の貯蔵安定性が向上し、また解像度が向上するとともに、放射線照射前の引き置き時間、放射線照射後の引き置き時間の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れたものとなる。

40

【0143】

本発明の感放射線性組成物には、本発明の目的を阻害しない範囲で、必要に応じて、その他の成分 (F) として、溶解促進剤、溶解制御剤、増感剤、界面活性剤、及び有機カルボン酸またはリンのオキソ酸もしくはその誘導体等の各種添加剤を 1 種又は 2 種以上添加することができる。

【0144】

(1) 溶解促進剤

50

低分子量溶解促進剤は、式（１）で示される環状化合物のアルカリ等の現像液に対する溶解性が低すぎる場合に、その溶解性を高めて、現像時の環状化合物の溶解速度を適度に増大させる作用を有する成分であり、本発明の効果を損なわない範囲で使用する事ができる。前記溶解促進剤としては、例えば、低分子量のフェノール性化合物を挙げることができる。例えば、ビスフェノール類、トリス（ヒドロキシフェニル）メタン等を挙げることができる。これらの溶解促進剤は、単独でまたは２種以上を混合して使用することができる。溶解促進剤の配合量は、使用する環状化合物の種類に応じて適宜調節されるが、固形成分全重量の０～４９重量％が好ましく、０～５重量％がより好ましく、０～１重量％がさらに好ましく、０重量％が特に好ましい。

【０１４５】

10

（２）溶解制御剤

溶解制御剤は、式（１）で示される環状化合物がアルカリ等の現像液に対する溶解性が高すぎる場合に、その溶解性を制御して現像時の溶解速度を適度に減少させる作用を有する成分である。このような溶解制御剤としては、レジスト被膜の焼成、放射線照射、現像等の工程において化学変化しないものが好ましい。

溶解制御剤としては、例えば、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン、アセナフテン等の芳香族炭化水素類；アセトフェノン、ベンゾフェノン、フェニルナフチルケトン等のケトン類；メチルフェニルスルホン、ジフェニルスルホン、ジナフチルスルホン等のスルホン類等を挙げることができる。これらの溶解制御剤は、単独でまたは２種以上を使用することができる。

20

溶解制御剤の配合量は、使用する環状化合物の種類に応じて適宜調節されるが、固形成分全重量の０～４９重量％が好ましく、０～５重量％がより好ましく、０～１重量％がさらに好ましく、０重量％が特に好ましい。

【０１４６】

（３）増感剤

増感剤は、照射された放射線のエネルギーを吸収して、そのエネルギーを酸発生剤（Ｃ）に伝達し、それにより酸の生成量を増加する作用を有し、レジストの見掛けの感度を向上させる成分である。このような増感剤としては、例えば、ベンゾフェノン類、ピアセチル類、ピレン類、フェノチアジン類、フルオレン類等を挙げることができるが、特に限定はされない。

30

これらの増感剤は、単独でまたは２種以上を使用することができる。増感剤の配合量は、使用する環状化合物の種類に応じて適宜調節されるが、固形成分全重量の０～４９重量％が好ましく、０～５重量％がより好ましく、０～１重量％がさらに好ましく、０重量％が特に好ましい。

【０１４７】

（４）界面活性剤

界面活性剤は、本発明の感放射線性組成物の塗布性やストリーション、レジストの現像性等を改良する作用を有する成分である。このような界面活性剤は、アニオン系、カチオン系、ノニオン系あるいは両性のいずれでもよい。好ましい界面活性剤はノニオン系界面活性剤である。ノニオン系界面活性剤は、感放射線性組成物の製造に用いる溶媒との親和性がよく、より効果がある。ノニオン系界面活性剤の例としては、ポリオキシエチレン高級アルキルエーテル類、ポリオキシエチレン高級アルキルフェニルエーテル類、ポリエチレングリコールの高級脂肪酸ジエステル類等が挙げられるが、特に限定はされない。市販品としては、以下商品名で、エフトップ（ジェムコ社製）、メガファック（大日本インキ化学工業社製）、フロラード（住友スリーエム社製）、アサヒガード、サーフロン（以上、旭硝子社製）、ペポール（東邦化学工業社製）、ＫＰ（信越化学工業社製）、ポリフロ（共栄社油脂化学工業社製）等を挙げることができる。

40

界面活性剤の配合量は、使用する環状化合物の種類に応じて適宜調節されるが、固形成分全重量の０～４９重量％が好ましく、０～５重量％がより好ましく、０～１重量％がさらに好ましく、０重量％が特に好ましい。

50

【0148】

(5) 有機カルボン酸またはリンのオキソ酸もしくはその誘導体

感度劣化防止またはレジストパターン形状、引き置き安定性等の向上の目的で、さらに任意の成分として、有機カルボン酸またはリンのオキソ酸もしくはその誘導体を含有させることができる。なお、酸拡散制御剤と併用することも出来るし、単独で用いても良い。有機カルボン酸としては、例えば、マロン酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、安息香酸、サリチル酸などが好適である。リンのオキソ酸もしくはその誘導体としては、リン酸、リン酸ジ-*n*-ブチルエステル、リン酸ジフェニルエステルなどのリン酸またはそれらのエステルなどの誘導体、ホスホン酸、ホスホン酸ジメチルエステル、ホスホン酸ジ-*n*-ブチルエステル、フェニルホスホン酸、ホスホン酸ジフェニルエステル、ホスホン酸ジベンジルエステルなどのホスホン酸またはそれらのエステルなどの誘導体、ホスフィン酸、フェニルホスフィン酸などのホスフィン酸およびそれらのエステルなどの誘導体が挙げられ、これらの中で特にホスホン酸が好ましい。

10

有機カルボン酸またはリンのオキソ酸もしくはその誘導体は、単独でまたは2種以上を使用することができる。有機カルボン酸またはリンのオキソ酸もしくはその誘導体の配合量は、使用する環状化合物の種類に応じて適宜調節されるが、固形成分全重量の0～49重量%が好ましく、0～5重量%がより好ましく、0～1重量%がさらに好ましく、0重量%が特に好ましい。

【0149】

(6) 上記溶解制御剤、増感剤、界面活性剤、及び有機カルボン酸またはリンのオキソ酸もしくはその誘導体以外のその他の添加剤

20

更に、本発明の感放射線性組成物には、本発明の目的を阻害しない範囲で、必要に応じて、上記溶解制御剤、増感剤、及び界面活性剤以外の添加剤を1種又は2種以上配合することができる。そのような添加剤としては、例えば、染料、顔料、及び接着助剤等が挙げられる。例えば、染料又は顔料を配合すると、露光部の潜像を可視化させて、露光時のハレーションの影響を緩和できるので好ましい。また、接着助剤を配合すると、基板との接着性を改善することができるので好ましい。更に、他の添加剤としては、ハレーション防止剤、保存安定剤、消泡剤、形状改良剤等、具体的には4-ヒドロキシ-4'-メチルカルコン等を挙げることができる。

【0150】

30

任意成分(F)の合計量は、固形成分全重量の0～49重量%が好ましく、0～5重量%がより好ましく、0～1重量%がさらに好ましく、0重量%が特に好ましい。

【0151】

本発明の感放射線性組成物の配合(環状化合物/酸発生剤(C)/酸架橋剤(G)/酸拡散制御剤(E)/任意成分(F))は、固形物基準の重量%で、好ましくは50～99.4/0.001～49/0.5～49/0.001～49/0～49、より好ましくは55～90/1～40/0.5～40/0.01～10/0～5、さらに好ましくは60～80/3～30/1～30/0.01～5/0～1、特に好ましくは60～70/10～25/2～20/0.01～3/0である。

各成分の配合割合は、その総和が100重量%になるように各範囲から選ばれる。上記配合にすると、感度、解像度、アルカリ現像性等の性能に優れる。

40

【0152】

本発明の感放射線性組成物は、通常は、使用時に各成分を溶媒に溶解して均一溶液とし、その後、必要に応じて、例えば孔径0.2 μm程度のフィルター等でろ過することにより調製される。

【0153】

本発明の感放射線性組成物の調製に使用される前記溶媒としては、例えば、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテルアセテート等のエチレングリコールモノアルキルエーテルアセ

50

テート類；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルなどのエチレングリコールモノアルキルエーテル類；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノー n −プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノー n −ブチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類；プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのプロピレングリコールモノアルキルエーテル類；乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸 n −プロピル、乳酸 n −ブチル、乳酸 n −アミル等の乳酸エステル類；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 n −プロピル、酢酸 n −ブチル、酢酸 n −アミル、酢酸 n −ヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル等の脂肪族カルボン酸エステル類；3−メトキシプロピオン酸メチル、3−メトキシプロピオン酸エチル、3−エトキシプロピオン酸メチル、3−エトキシプロピオン酸エチル、3−メトキシ−2−メチルプロピオン酸メチル、3−メトキシブチルアセテート、3−メチル−3−メトキシブチルアセテート、3−メトキシ−3−メチルプロピオン酸ブチル、3−メトキシ−3−メチル酪酸ブチル、アセト酢酸メチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル等の他のエステル類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；2−ヘプタノン、3−ヘプタノン、4−ヘプタノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン等のケトン類；N，N−ジメチルホルムアミド、N−メチルアセトアミド、N，N−ジメチルアセトアミド、N−メチルピロリドン等のアミド類； γ −ラクトン等のラクトン類等を挙げることができるが、特に限定はされない。これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を使用することができる。

【0154】

本発明の感放射線組成物は、本発明の目的を阻害しない範囲で、アルカリ水溶液に可溶である樹脂を含むことができる。アルカリ水溶液に可溶である樹脂としては、ノボラック樹脂、ポリビニルフェノール類、ポリアクリル酸、ポリビニルアルコール、スチレン−無水マレイン酸樹脂、およびアクリル酸、ビニルアルコール、またはビニルフェノールを単量体単位として含む重合体、あるいはこれらの誘導体などが挙げられる。アルカリ水溶液に可溶である樹脂の配合量は、使用する式(1)の環状化合物の種類に応じて適宜調節されるが、上記環状化合物100重量部当たり、30重量部以下が好ましく、より好ましくは10重量部以下、さらに好ましくは5重量部以下、特に好ましくは0重量部である。

【0155】

レジストパターンの形成方法

本発明は、上記本発明の感放射線組成物を用いて、基板上にレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を露光する工程、および前記レジスト膜を現像してレジストパターンを形成する工程を含むレジストパターン形成方法に関する。本発明のレジストパターンは多層レジストプロセスにおける上層レジストとして形成することもできる。

レジストパターンを形成するには、まず、従来公知の基板上に前記本発明の感放射線組成物を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の塗布手段によって塗布することによりレジスト膜を形成する。従来公知の基板とは、特に限定されず、例えば、電子部品用の基板や、これに所定の配線パターンが形成されたもの等を例示することができる。より具体的には、シリコンウエハー、銅、クロム、鉄、アルミニウム等の金属製の基板や、ガラス基板等が挙げられる。配線パターンの材料としては、例えば銅、アルミニウム、ニッケル、金等が挙げられる。また必要に応じて、前述基板上に無機系および／または有機系の膜が設けられたものであってもよい。無機系の膜としては、無機反射防止膜（無機BARC）が挙げられる。有機系の膜としては、有機反射防止膜（有機BARC）が挙げられる。ヘキサメチレンジシラザン等による表面処理を行ってもよい。

次いで、必要に応じ、塗布した基板を加熱する。加熱条件は、感放射線組成物の配合組成等により変わるが、20〜250℃が好ましく、より好ましくは20〜150℃である。加熱することによって、レジストの基板に対する密着性が向上する場合があります。次いで、可視光線、紫外線、エキシマレーザー、電子線、極端紫外線（EUV）、X線、およびイオンビームからなる群から選ばれるいずれかの放射線により、レジスト膜を

所望のパターンに露光する。露光条件等は、感放射線性組成物の配合組成等に応じて適宜選定される。本発明においては、露光における高精度の微細パターンを安定して形成するために、放射線照射後に加熱するのが好ましい。加熱条件は、感放射線性感放射線性組成物の配合組成等により変わるが、20～250℃が好ましく、より好ましくは20～150℃である。

【0156】

次いで、露光されたレジスト膜をアルカリ現像液で現像することにより、所定のレジストパターンを形成する。前記アルカリ現像液としては、例えば、モノー、ジーあるいはトリアルキルアミン類、モノー、ジーあるいはトリアルカノールアミン類、複素環式アミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）、コリン等のアルカリ性化合物の1種以上を、好ましくは1～10質量%、より好ましくは1～5質量%の濃度となるように溶解したアルカリ性水溶液が使用される。上記アルカリ性水溶液の濃度が10質量%以下とすると、露光部が現像液に溶解することを抑制することが出来るので好ましい。

10

また、前記アルカリ現像液には、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコールなどのアルコール類や前記界面活性剤を適量添加することもできる。これらのうちイソプロピルアルコールを10～30質量%添加することが特に好ましい。これにより、レジストに対する現像液の濡れ性を高めることが出来るので好ましい。なお、このようなアルカリ性水溶液からなる現像液を用いた場合は、一般に、現像後、水で洗浄する。

【0157】

レジストパターンを形成した後、エッチングすることによりパターン配線基板が得られる。エッチングの方法はプラズマガスを使用するドライエッチングおよびアルカリ溶液、塩化第二銅溶液、塩化第二鉄溶液等によるウェットエッチングなど公知の方法で行うことが出来る。

20

レジストパターンを形成した後、めっきを行うことも出来る。上記めっき法としては、例えば、銅めっき、はんだめっき、ニッケルめっき、金めっきなどがある。

エッチング後の残存レジストパターンは有機溶剤や現像に用いたアルカリ水溶液より強アルカリ性の水溶液で剥離することが出来る。上記有機溶剤として、PGMEA（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）、PGME（プロピレングリコールモノメチルエーテル）、EL（乳酸エチル）等が挙げられ、強アルカリ水溶液としては、例えば1～20質量%の水酸化ナトリウム水溶液や1～20質量%の水酸化カリウム水溶液が挙げられる。上記剥離方法としては、例えば、浸漬方法、スプレー方式等が挙げられる。またレジストパターンが形成された配線基板は、多層配線基板でも良く、小径スルーホールを有していても良い。

30

本発明で得られる配線基板は、レジストパターン形成後、金属を真空中で蒸着し、その後レジストパターンを溶液で溶かす方法、すなわちリフトオフ法により形成することもできる。

【実施例】

【0158】

以下、実施例を挙げて、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に限定はされない。以下の合成例、実施例において、化合物の構造は¹H-NMR測定で確認した。

40

【0159】

合成例1

CR-1A（環状化合物（A））の合成

十分乾燥し、窒素置換した滴下漏斗、ジム・ロート氏冷却管、温度計、攪拌翼を設置した四つ口フラスコ（1000L）に、窒素気流下で、関東化学社製レゾルシノール（22g、0.2mol）と、4-イソプロピルベンズアルデヒド（29.6g、0.2mol）と、脱水エタノール（200mL）を投入し、エタノール溶液を調整した。この溶液を攪拌しながらマントルヒーターで85℃まで加熱した。次いで濃塩酸（35%）75mLを、滴下漏斗により30分かけて滴下した後、引き続き85℃で3時間攪拌した。反応終

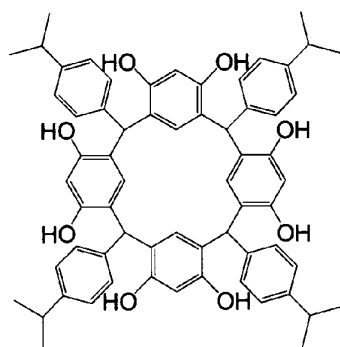
50

了後、放冷し、室温に到達させた後、氷浴で冷却した。1時間静置後、淡黄色の目的粗結晶が生成し、これを濾別した。粗結晶をメタノール500mLで2回洗浄し、濾別、真空乾燥させることにより、45.6gの化合物を得た。この化合物は、LC-MSで分析した結果、目的化合物の分子量960を示した。また重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δppm, TMS基準)は1.1~1.2(m, 24H)、2.6~2.7(m, 4H)、5.5(s, 4H)、6.0~6.8(m, 24H)、8.4~8.5(d, 8H)であった。これらの結果から得られた化合物を目的化合物(CR-1A)と同定した(収率95%)。

【0160】

【化43】

10



(CR-1A)

20

【0161】

合成例2

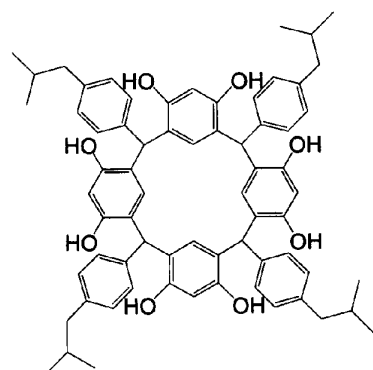
CR-2A(環状化合物(A))の合成

4-イソプロピルベンズアルデヒドをイソブチルベンズアルデヒドに代えた以外は合成例1と同様に合成し、49.0gの化合物を得た。この化合物は、LC-MSで分析した結果、目的物の分子量1017を示した。また得られた生成物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δppm, TMS基準)は1.0(m, 24H)、2.2(m, 4H)、2.5(m, 8H)、5.5(d, 4H)、5.8~6.8(m, 24H)、8.4~8.6(t, 8H)であった。これらの結果から得られた化合物を目的化合物(CR-2A)と同定した(収率96%)。

30

【0162】

【化44】



(CR-2A)

40

【0163】

合成例3

CR-3A(環状化合物(A))の合成

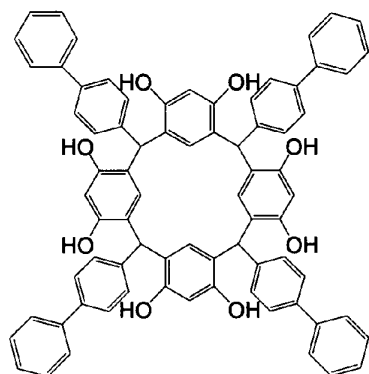
4-イソプロピルベンズアルデヒドをビフェニルアルデヒドに代えた以外は合成例1と同様に合成し、53.5gの化合物を得た。この化合物は、LC-MSで分析した結果、目的化合物の分子量1096を示した。また得られた生成物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δppm, TMS基準)は6.0~7.4(m, 48H)、8.6~8.7(t, 8H)であった。これらの結果から得られた化合物

50

を目的化合物（CR-3A）と同定した（収率98%）。

【0164】

【化45】



(CR-3A)

10

【0165】

合成例4

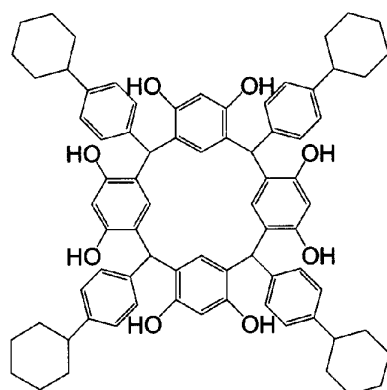
CR-4A（環状化合物（A））の合成

4-イソプロピルベンズアルデヒドを4-シクロヘキシルベンズアルデヒド（46.0 g, 0.2 mol）に代えた以外は合成例1と同様に合成し、50 gの化合物を得た。この化合物は、LC-MSで分析した結果、目的化合物の分子量1121を示した。また重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値（δ ppm, TMS基準）は0.8~1.9（m, 44H）、5.5~5.6（d, 4H）、6.0~6.8（m, 24H）、8.4~8.5（m, 8H）であった。これらの結果から得られた化合物を目的化合物（CR-4A）と同定した（収率91%）。

20

【0166】

【化46】



(CR-4A)

30

【0167】

合成参考例1

CR-1（環状化合物）の合成

40

十分乾燥し、窒素置換した滴下漏斗、ジム・ロート氏冷却管、温度計、攪拌翼を設置した四つ口フラスコ（1000 L）に、窒素気流下で、合成例1で合成したCR-1A 9.6 g（10 mmol）、トリエチルアミン4 g（40 mmol）および300 mLのN-メチル-2-ピロリドンからなる溶液に、ヨウ化メチル5.8 g（40 mmol）を滴下した。反応液を10時間室温で攪拌した。反応終了後、溶媒を除去し、得られた固体を、ヘキサン／酢酸エチル=1／3の混合溶媒を用い、カラムクロマトで精製し、10.2 gの化合物を得た。

また得られた化合物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値（δ ppm, TMS基準）は1.0（m, 24H）、2.0~2.2（m, 4H）、2.5（m, 8H）、3.7（m, 12H）、5.5（m, 4H）、5.8~6.8（m

50

、2.4 H)、8.4~8.6 (m, 4 H)であった。これらの結果から得られた化合物を、CR-1Aのフェノール性水酸基の水素原子の50mol%がメチル基で置換された化合物(CR-1)と同定した。

【0168】

合成参考例2

CR-2 (環状化合物) の合成

CR-1AをCR-2Aに代えた以外は合成参考例1と同様に合成して10.9gの化合物を得た。

得られた化合物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δ ppm, TMS基準)は1.0 (m, 2.4 H)、2.1~2.2 (m, 4 H)、2.5 (m, 8 H)、3.7 (m, 1.2 H)、5.5 (d, 4 H)、5.8~6.8 (m, 2.4 H)、8.4~8.6 (m, 4 H)であった。これらの結果から得られた化合物を、CR-2Aのフェノール性水酸基の水素原子の50mol%がメチル基で置換された化合物(CR-2)と同定した。

【0169】

合成参考例3

CR-3 (環状化合物) の合成

CR-1AをCR-3Aに代えた以外は合成参考例1と同様に合成して11.0gの化合物を得た。

得られた化合物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δ ppm, TMS基準)は3.7 (m, 1.2 H)、6.0~7.4 (m, 4.8 H)、8.6~8.7 (m, 4 H)であった。これらの結果から得られた化合物を、CR-3Aのフェノール性水酸基の水素原子の50mol%がメチル基で置換された化合物(CR-3)と同定した。

【0170】

合成実施例1

CR-4 (環状化合物) の合成

CR-1AをCR-4Aに代えた以外は合成参考例1と同様に合成して11.0gの化合物を得た。

得られた化合物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δ ppm, TMS基準)は0.8~1.9 (m, 4.4 H)、3.7 (m, 1.2 H)、5.5, 5.6 (m, 4 H)、6.0~6.8 (m, 2.4 H)、8.4~8.5 (m, 4 H)であった。これらの結果から得られた化合物を、CR-4Aのフェノール性水酸基の水素原子の50mol%がメチル基で置換された化合物(CR-4)と同定した。

【0171】

合成実施例2

CR-5 (環状化合物) の合成

ヨウ化メチルの使用量を2.9g (20mmol) に代えた以外は合成実施例1と同様に合成して9.0gの化合物を得た。

得られた化合物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値(δ ppm, TMS基準)は0.8~1.9 (m, 4.4 H)、3.7 (m, 6 H)、5.5, 5.6 (m, 4 H)、6.0~6.8 (m, 2.4 H)、8.4~8.5 (m, 6 H)であった。これらの結果から得られた化合物を、CR-4Aのフェノール性水酸基の水素原子の25mol%がメチル基で置換された化合物(CR-5)と同定した。

【0172】

合成実施例3

CR-6 (環状化合物) の合成

ヨウ化メチルの使用量を11.0g (80mmol) に代えた以外は合成実施例1と同様に合成して12.0gの化合物を得た。

得られた化合物の重ジメチルスルホキシド溶媒中での¹H-NMRのケミカルシフト値

(δ ppm, TMS基準)は0.8～1.9 (m, 44H)、3.7 (m, 18H)、5.5, 5.6 (m, 4H)、6.0～6.8 (m, 24H)、8.4～8.5 (m, 2H)であった。これらの結果から得られた化合物を、CR-4Aのフェノール性水酸基の水素原子の75mol%がメチル基で置換された化合物(CR-6)と同定した。

【0173】

参考例1～3、実施例1～3及び比較例1～4

(1) 化合物の安全溶媒溶解度試験

上記合成参考例1～3、合成実施例1～3および合成例1～4で得られた化合物のプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)、およびシクロヘキサノン(CHN)への溶解量を評価した。結果を第1表に示す。

A: 20.0wt% ≤ 溶解量

B: 1.0wt% ≤ 溶解量 < 20.0wt%

C: 溶解量 < 1.0wt%

【0174】

【表1】

第1表

	化合物	PGME	CHN
参考例1	CR-1	A	A
参考例2	CR-2	B	B
参考例3	CR-3	B	B
実施例1	CR-4	A	A
実施例2	CR-5	A	A
実施例3	CR-6	A	A
比較例1	CR-1A	B	B
比較例2	CR-2A	C	B
比較例3	CR-3A	C	B
比較例4	CR-4A	B	B

【0175】

実施例4～8、参考例4及び比較例5～8

(2) パターニング試験

第2表記載の成分を調合し、均一溶液としたのち、孔径0.1μmのテフロン(登録商標)製メンブランフィルターで濾過して、感放射線性組成物を調製し、各々について以下の評価を行った。結果を第3表に示す。

(2-1) 解像度の評価

レジストを清浄なシリコンウェハー上に回転塗布した後、110℃のオーブン中で露光前バーク(PB)して、厚さ60nmのレジスト膜を形成した。該レジスト膜を電子線描画装置(ELS-7500, (株)エリオニクス社製)を用いて、50nm間隔の1:1のラインアンドスペース設定の電子線を照射した。照射後に、それぞれ所定の温度で、90秒間加熱し、2.38重量% TMAH水溶液に60秒間浸漬して現像を行った。その後、水で30秒間洗浄し、乾燥して、ネガ型のレジストパターンを形成した。得られたラインアンドスペースを走査型電子顕微鏡((株)日立ハイテクノロジー製S-4800)により観察した。またその際のドーズ量($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)を感度とした。結果を第3表に示す。

【0176】

(2-2) パターン形状の評価

得られた50nm間隔の1:1のラインアンドスペースの断面写真を走査型電子顕微鏡((株)日立ハイテクノロジー製S-4800)により観察し、評価した。結果を第3表に示す。

A: 矩形パターン(良好なパターン)

B: ほぼ矩形パターン(ほぼ良好なパターン)

C: 矩形ではないパターン(良好でないパターン)

【0177】

(2-3) ラインエッジラフネス(LER)の評価

50nm間隔の1:1のラインアンドスペースの長さ方向(0.75μm)の任意の300点において、日立半導体用SEMターミナルPC V5オフライン測長ソフトウェア((株)日立サイエンスシステムズ製)を用いて、エッジと基準線との距離を測定した。測定結果から標準偏差(3σ)を算出した。結果を第3表に示す。

A: $LER(3\sigma) \leq 3.5\text{ nm}$ (良好なLER)

C: $3.5\text{ nm} < LER(3\sigma)$ (良好でないLER)

【0178】

【表2】

第2表

	化合物	酸発生剤(C)	酸架橋剤(G)	酸拡散制御剤(E)	溶媒
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
実施例4	CR-4	P-1	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
実施例5	CR-4	P-2	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
実施例6	CR-4	P-1	C-2	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
実施例7	CR-5	P-1	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
実施例8	CR-6	P-1	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
参考例4	CR-1	P-1	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
比較例5	CR-4A	P-1	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
比較例6	CR-4A	P-2	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
比較例7	CR-4A	P-1	C-2	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0
比較例8	CR-1A	P-1	C-1	Q-1	S-1
	1.0	0.3	0.3	0.03	30.0

10

20

30

40

50

【0179】

(C) 酸発生剤

P-1：トリフェニルベンゼンスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート（みどり化学（株））

P-2：トリフェニルベンゼンスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート（みどり化学（株））

(G) 酸架橋剤

C-1：ニカラックMW-100LM(三和ケミカル(株))

C-2：ニカラックMX-270（三和ケミカル(株)）

10

(E) 酸拡散制御剤

Q-1：トリオクチルアミン（東京化成工業（株））

溶媒

S-1：プロピレングリコールモノメチルエーテル（東京化成工業(株)）

【0180】

【表3】

第3表

	PEB	感度	パターン形状	LER (3σ)
	(°C)	($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)		
実施例4	110	25.0	A	A
実施例5	110	25.0	B	A
実施例6	110	25.0	A	A
実施例7	110	30.0	A	A
実施例8	110	20.0	A	A
参考例4	110	70.0	A	A
比較例5	110	30.0	A	A
比較例6	110	30.0	B	A
比較例7	110	30.0	A	A
比較例8	110	80.0	A	A

20

30

PEB：電子線照射後に加熱する際の温度

【0181】

上記のように、本発明の化合物を含む組成物是对応する比較化合物を含む組成物に比べてより高感度で、かつ、良好な形状のレジストパターンを形成することができる。上記した本発明の要件を満たす限り、実施例に記載したもの以外の化合物も同様の効果を示す。

【産業上の利用可能性】

40

【0182】

本発明は、酸増幅型非高分子系レジスト材料として有用な、特定の化学構造式で示される環状化合物、これを含む感放射線性組成物、および該感放射線性組成物を用いるレジストパターン形成方法に好適に使用される。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I		
	G 0 3 F	7/038	5 0 5
	C 0 7 B	61/00	3 0 0

(56)参考文献 特開平10-161349 (JP, A)

国際公開第2009/060869 (WO, A1)

国際公開第2009/075307 (WO, A1)

国際公開第2009/075308 (WO, A1)

国際公開第2008/053974 (WO, A1)

European Journal of Organic Chemistry, 2006年, (22), p.5117-5134

European Journal of Organic Chemistry, 2006年, (22), p.5135-5151

European Journal of Organic Chemistry, 2003年, (8), p.1404-1409

Journal of Organic Chemistry, 2006年, 71(3), p.976-982

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C 0 7 C 3 9 / 1 7

C 0 7 C 3 7 / 1 8

G 0 3 F 7 / 0 0 4

G 0 3 F 7 / 0 3 8

C 0 7 B 6 1 / 0 0

H 0 1 L 2 1 / 0 2 7

C A p l u s / R E G I S T R Y (S T N)